

Міністерство культури України
Одеська національна наукова бібліотека

Вчені Одеси

Серія заснована 1957 року

Випуск 50

Олександр
Олександрович
Птащенко

Біобібліографічний
показчик літератури

Упорядник
А. В. Іванченко

Одеса
2018

Олександр Олександрович Птащенко : біобібліогр. покажч. / ОННБ ;
упоряд. А. В. Іванченко ; наук. керівник В. І. Михайленко ; ред.
І. С. Шелестович. – Одеса, 2018. – 85 с. : іл. – (Серія «Вчені Одеси» ;
вип. 50).

Цей випуск серії біобібліографічних покажчиків «Вчені Одеси» присвячено Олександру Олександровичу Птащенку – доктору фізико-математичних наук, професору, поету, публіцисту, громадському діячу, члену Національної спілки письменників України.

При укладанні посібника використовувалися фонди Одеської національної наукової бібліотеки, наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, інших бібліотек міста та особистий архів ученого.

У покажчик включені біографічна довідка, хронологічний покажчик наукових праць, перелік публіцистичних праць, поетичних творів, вибрані поезії, література про життя, творчу, наукову та громадську діяльність, списки патентів та авторських свідоцтв на винаходи, а також дисертацій, які були захищені під керівництвом ученого. Доповнюють видання алфавітний покажчик наукових праць, покажчики періодичних видань та імен. Зірочками позначені окремі видання та публікації, не переглянуті *de visu*.

Посібник адресовано науковцям, викладачам, студентам, бібліотечним працівникам та всім тим, хто цікавиться історією науки.

Науковий керівник
В. І. Михайленко,
доктор фізико-математичних наук, професор

Редактор
І. С. Шелестович

© А. В. Іванченко. Упорядкування, 2018

© М. О. Архипова. Обкладинка, 2018

© ОННБ, 2018

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Олександр Птащенко є унікальною людиною в нашій Одесі. Доктор фізико-математичних наук і поет, і фізик, і лірик в одній особі!

О. Різників

Олександр Олександрович Птащенко народився 10 січня 1940 р. у с. Журавка, Миколаївського району, Одеської області. Батько, Олександр Іванович, був ковалем, останнім із роду ковалів, що в селі Шабельники виготовляли козацьку зброю, коваль від Бога, гарний музикант, відомий в окрузі мисливець, весела і дотепна людина. Повернувшись із війни тяжко хворим, помер у 40 років, коли Олександрові, наймолодшому з чотирьох дітей, було сім років. Батько став для сина взірцем на все його життя. Мати, Ганна Тимофіївна, виростила дітей і допомогла їм здобути освіту.

1953 р. Олександр закінчив Журавську семирічну школу. У восьмий клас пішов до Червонокутської школи (Ширяєвський район, Одеської області). У 1961 р. закінчив фізичний факультет Одеського державного (нині – національного) університету імені І. І. Мечникова, у 1965 – аспірантуру ОДУ. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук «Дослідження домішкової фотопровідності та її інфрачервоного гасіння в напівпровідникових речовинах типу CdS» («Исследование примесной фотопроводимости и ее инфракрасного гашения в полупроводниковых веществах типа CdS») захистив 1968 р. під науковим керівництвом засновника і директора Інституту фізики напівпровідників НАН України (Київ) академіка НАН України В. Є. Лашкарьова. У вченому званні доцента був затверджений 1972 р.

З 1963 р. працював в університеті: асистент, старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри фізики твердого тіла та твердотільної електроніки (2005–2017), заснованої професором В. О. Пресновим у 1969 р. (тоді – кафедра фізичної електроніки).

При кафедрі була створена Галузева науково-дослідна лабораторія фізичних основ електронної техніки Міністерства електронної промисловості СРСР. У той період швидко зріс випуск світловипромінюючих структур, таких як світлодіоди і напівпровідникові лазери. У зв'язку з цим гостро постала

проблема вивчення їх деградації, і відповідальним виконавцем першої теми з дослідження деградаційних явищ у світловипромінюючих діодах на основі сполук $A^{III}B^V$ став саме О. О. Птащенко.

Від часу заснування кафедри брав активну участь у створенні її лекційних курсів і практикумів. Розробив і читав курси з нелінійної оптики та квантової електроніки, з проблем сучасної фізики, спецкурси з фізичних основ оптоелектроніки і квантової електроніки. Розробив спецпрактикуми з оптоелектроніки та квантової електроніки. Керував науково-дослідницькою групою науковців. Під керівництвом професора О. О. Птащенка захищено 12 кандидатських дисертацій. Його учні працюють у вищих навчальних закладах України, у США, у країнах Європи, Азії та Африки.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук «Нерівноважні процеси в сильних електричних полях у випромінюючих структурах з потенціальними бар'єрами на основі напівпровідників $A^{III}B^V$ » захистив у Києві 1987 р. українською мовою. Тоді ж почав викладати квантову електроніку і оптоелектроніку українською мовою. Вчене звання професора було присвоєне 1989 р.

Наукові інтереси: фізика напівпровідників (випромінювальна та невипромінювальна рекомбінація, явища в сильних полях, тунельні явища, фотохімічні реакції, розмноження дислокацій та їх рекомбінаційна роль, поверхнева рекомбінація); оптоелектроніка (напівпровідникові лазери, світлодіоди, багат шарові гетероструктури, ізотипні гетероструктури, S-діоди, фотодіоди, сонячні елементи; рекомбінаційні та хвилепровідні явища, деградація, механічні напруження, поляризаційні явища, нелінійні ефекти, просторово-неоднорідні процеси); фізика хімічних сенсорів, комп'ютерне моделювання фізичних процесів у напівпровідникових структурах.

Науковий керівник низки досліджень з держбюджетних тем, зокрема, з деградаційних процесів у світловипромінюючих структурах, просторових властивостей та поляризації випромінювання лазерних гетероструктур; дослідження поверхневих явищ і нерівноважних процесів у шаруватих структурах оптоелектроніки; дослідження квантово-розмірних оптичних явищ у наночастинках галоїдів срібла, сформованих у шпаристих силікатних стеклах.

Розробив вискоєфективні напівпровідникові джерела світла без р-n-переходу, високочутливі сенсори температури і магнітного поля на основі р-i-n-структур. Запропонував ряд моделей деградаційних процесів в оптоелектронних приладах, у тому числі – у лазерах.

Узагальнив феноменологічну теорію проходження струму в напівпровідникових структурах з потенціальними бар'єрами з урахуванням тунельної рекомбінації носіїв заряду через глибокі рівні поблизу дислокацій та на поверхні. Вивчив також закономірності деградації та розробив моделі деградаційних процесів, пов'язаних з генерацією, перенесенням та накопиченням дефектів у неоднорідних напівпровідникових р-n-, р-i-n-, n-i-n-структурах. Розробив методики діагностики деградаційних процесів у напівпровідникових приладах. Встановив закономірності низки поляризаційних явищ у напівпровідникових лазерах, які можна використовувати для створення диференційних оптоелектронних сенсорів та для діагностики надійності напівпровідникових лазерів.

Головним своїм досягненням професор О. О. Птащенко вважає книгу «Основи квантової електроніки», перший в Україні навчальний посібник з квантової електроніки такого обсягу, який широко використовують вітчизняні провідні університети. Він є також автором першого в Україні навчального посібника «Основи нелінійної фізики».

Протягом 2003-2005 рр. очолював Одеське обласне об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка. Силами «Просвіти» в Одесі в 2004 р. проведено II Міжнародну науково-практичну конференцію «Українська національна ідея: минуле, сучасне, майбутнє».

Важливою справою була також організація (в тому числі фінансова) встановлення в Одесі трьох меморіальних дошок: засновникові кафедри – лауреату Державної премії України професору Віктору Олексійовичу Преснову (це була перша в Одесі меморіальна дошка вченому-фізику); Михайлу Комарову – видатному діячеві культури України кінця XIX – початку XX ст. та одному із засновників одеської «Просвіти»; народному артисту України, лауреату премії Олексія Попова Миколі Йосиповичу Сльозці (сьогодні це єдина в Одесі меморіальна дошка українському актору).

З дитинства пише вірші. У 1980-ті почав писати патріотичні вірші й читати їх на зібраннях науковців. Займається

також публіцистичною діяльністю. Його поезії та статті публікуються у періодичних виданнях Одеси, Києва, Івано-Франківська, Чернівців, Миколаєва, а також у США. Він автор збірок «Любов і біль», «Нищені – не знищені», «Вклоняюсь Вам», «Наша Голгофа. Думи» (два видання).

Особливо важливим у літературній творчості Олександра Птащенка став жанр сучасної літературної думи, який дозволяє правдиво, яскраво й емоційно відобразити героїчні та трагічні події у сучасній боротьбі за незалежність України, а також оспівувати наших героїв. Що стосується тематики публіцистичних статей, то вони, здебільшого, присвячені науковому, культурному та громадсько-політичному життю Одеси та України в цілому. Є також низка статей, що відображають трагічні сторінки нашої історії.

Член Українського фізичного товариства та Національної спілки письменників України.

Нагороджений медаллю «За освоєння цілинних земель», почесними грамотами Одеської облдержадміністрації (2004) та Одеської облради (2010), відзначений медаллю «Просвіти» «Будівничий України».

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1965

1. ИК-гашение в CdS при различной степени участия g -канала в рекомбинации // Тезисы докладов научной конференции физического факультета, посвященной 100-летию Одесского государственного университета. – Одесса, 1965. – С. 20–22.
2. Инфракрасное гашение примесной фотопроводимости сульфида кадмия / соавт. В. В. Сердюк // Тезисы докладов Четвертого Всесоюзного совещания по фотоэлектрическим явлениям в полупроводниках. – Одесса, 1965. – С. 90.
3. Исследование стационарного инфракрасного гашения фототока в CdS // УФЖ. – 1965. – Т. 10, № 12. – С. 1341–1348.
4. К вопросу об инфракрасном гашении фотопроводимости в монокристаллах CdS // УФЖ. – 1965. – Т. 10, № 3. – С. 303–311.

1966

5. Инфракрасное гашение примесной фотопроводимости в сульфиде кадмия / соавт.: В. В. Сердюк, И. А. Кузьменко // ФТТ. – 1966. – Т. 8, № 5. – С. 1623–1625.
6. Исследование спектральной зависимости фотоионизации очувствляющих центров в сульфиде кадмия / соавт. В. Е. Лашкарев // Тезисы докладов Всесоюзного совещания по полупроводниковым соединениям A^2B^6 и их применению. – Киев, 1966. – С. 51. – Те саме // ДАН СССР. – 1967. – Т. 172, № 1. – С. 77–79.
7. Особенности стационарных люкс-амперных характеристик примесной фотопроводимости с очувствляющих центров в сернистом кадмии // Тезисы докладов Всесоюзного совещания по полупроводниковым соединениям A^2B^6 и их применению. – Киев, 1966. – С. 16. – Те саме // УФЖ. – 1967. – Т. 12, № 3. – С. 471–473.

1967

8. Роль центров красной люминесценции в процессах фотопроводимости в CdS // ФТП. – 1967. – Т. 1, № 6. – С. 866–868.

1968

9. Исследование примесной фотопроводимости и ее инфракрасного гашения в полупроводниковых веществах типа CdS : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / ОГУ. – Одесса, 1968. – 13 с.

1969

10. Кинетика примесной фотопроводимости полупроводников типа CdS / соавт. В. Е. Лашкарев // Тезисы докладов Второго Всесоюзного совещания по физике и химии соединений типа A^2B^6 . – Киев, 1969. – С. 100. – Те саме // УФЖ. – 1970. – Т. 15, № 7. – С. 1108–1115.

1970

11. Влияние величины тока на спектр излучения светодиодов на основе арсенида галлия / соавт.: В. А. Преснов [и др.] // Материалы Четвертого Всесоюзного совещания по физическим явлениям в p-n-переходах в полупроводниках. – Одесса, 1970. – С. 31.

12. Исследование поверхностных токов в p-n-переходах на основе арсенида галлия / соавт.: В. А. Преснов, И. Е. Былина, А. П. Овчинникова // Материалы Четвертого Всесоюзного совещания по физическим явлениям в p-n-переходах в полупроводниках. – Одесса, 1970. – С. 30.

13. Исследование старения светодиодов на основе арсенида галлия / соавт.: В. А. Преснов, И. И. Круглов, Н. Н. Голембиевский // Материалы Четвертого Всесоюзного совещания по физическим явлениям в p-n-переходах в полупроводниках. – Одесса, 1970. – С. 39.

14. Сопоставление различных механизмов деградации светодиодов на основе арсенида галлия / соавт.: В. А. Преснов, И. И. Круглов, Н. Н. Голембиевский // Материалы Четвертого Всесоюзного совещания по физическим явлениям в р-п-переходах в полупроводниках. – Одесса, 1970. – С. 39.

15. Температурное гашение электролюминесценции в светодиодах на основе арсенида галлия с примесью цинка / соавт.: В. А. Преснов [и др.] // Материалы Четвертого Всесоюзного совещания по физическим явлениям в р-п-переходах в полупроводниках. – Одесса, 1970. – С. 28.

16. Температурные зависимости избыточных и обратных токов в р-п-переходах на основе арсенида галлия / соавт.: В. А. Преснов, Л. Ф. Литовченко, Н. Н. Голембиевский // Материалы Четвертого Всесоюзного совещания по физическим явлениям в р-п-переходах в полупроводниках. – Одесса, 1970. – С. 30.

1971

17. Влияние уменьшения концентрации акцепторов в процессе старения на свойства светодиодов / соавт.: В. А. Преснов [и др.] // Электрон. техника. – 1971. – № 7. – С. 8–15. – (Серия 2, Полупроводниковые приборы).

18. Избыточные токи и старение светодиодов на основе СаАs / соавт.: В. А. Преснов [и др.] // Электрон. техника. – 1971. – № 7. – С. 16–20. – (Серия 2, Полупроводниковые приборы).

1972

19. Влияние избыточных токов на температурное гашение электролюминесценции светодиодов на основе GaAs / соавт.: В. А. Преснов [и др.] // ФТП. – 1972. – Т. 6, вып. 1. – С. 215. – Деп. в ЦНИИ «Электроника» 28.09.1971, ДЭ–454.

20. Двойные оптические переходы через глубокие уровни и спектральное преобразование электромагнитного излучения // Совещание по глубоким центрам в полупроводниках. – Одесса, 1972. – С. 96.

1973

21. Деградация светодиодов на основе $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$ и $\text{Ga}_{1-x}\text{Al}_x\text{As}$ / соавт.: В. А. Преснов [и др.] // Электрон. техника. – 1973. – № 2. – С. 37–44. – (Серия 2, Полупроводниковые приборы).

1974

22. Двойные оптические переходы и антистоксова люминесценция // УФЖ. – 1974. – Т. 19, № 5. – С. 813–817.

1975

23. Деградация излучения $\text{GaAs}:\text{Si}$ -светодиодов при высоких плотностях тока // ФТП. – 1975. – Т. 9, №10. – С. 2043–2054. – Деп. в ЦНИИ «Электроника» 1975, №3322/75.

24. Механизмы деградации и прогнозирование срока службы оптоэлектронных устройств на р-n-переходах // Тезисы докладов Седьмой Всесоюзной научно-технической конференции по микроэлектронике. – Львов, 1975. – С. 112–113.

1976

25. Ионная проводимость и нестационарное распределение примесных центров в полупроводниках с р-n-переходом // Тезисы докладов Четвертого Всесоюзного совещания «Физика, химия и технические применения полупроводников A^2B^6 ». – Киев, 1976. – С. 167.

26. Исследование механизмов деградации светоизлучающих диодов на основе $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$ и $\text{Ga}_{1-x}\text{Al}_x\text{As}$ при низких уровнях инжекции / соавт.: В. П. Сушков [и др.] // Электрон. техника. – 1976. – № 8. – С. 41–54. – (Серия 2, Полупроводниковые приборы).

27. Исследование фотопроводимости $n^+n\text{-}v\text{-}n^+$ -гетероструктур $\text{GaAs} - \text{Ga}_{1-x}\text{Al}_x\text{As} - \text{Ga}_{1-y}\text{Al}_y\text{As} - \text{GaAs}$ / соавт. Ф. П. Тимохов // Вопр. физики твердого тела. – 1976. – С. 153–157.

28. Исследование р-i-n-структур на основе $\text{GaAs}(o)$ / соавт. В. И. Марютин. – Деп. 12.03.76, № 772–76.

29. Методы исследования стабильности СИД / соавт.: В. М. Баранов [и др.] // Тезисы докладов Второй Всесоюзной научно-технической конференции «Фотометрия и ее метрологическое обеспечение». – Москва, 1976. – С. 154.

30. Механизмы оптического гашения люминесценции в полупроводниках с несколькими каналами рекомбинации // Тезисы докладов Четвертого Всесоюзного совещания «Физика, химия и технические применения полупроводников A_2B_6 ». – Киев, 1976. – С. 167–168.

31. Монополярная инжекция и лавинное умножение носителей заряда в высокоомных слоях полупроводников / соавт. Ф. П. Тимохов // Тезисы докладов Четвертого Всесоюзного совещания «Физика, химия и технические применения полупроводников A_2B_6 ». – Киев, 1976. – С. 168.

1977

32. Деградация светоизлучающих диодов на основе GaAs, $Ga_{1-x}Al_xAs$ и $GaAs_{1-x}P_x$ и накопление примесных центров в р-n-переходах / соавт.: В. М. Баранов, Л. Ф. Литовченко, В. А. Тепляков // Тезисы докладов Шестой Всесоюзной конференции по электролюминесценции. – Днепропетровск, 1977. – С. 53–54. – Те саме // Вопросы физики электролюминесценции : материалы Четвертой Всесоюз. конф. по электролюминесценции. – Днепропетровск, 1979. – С. 132–139.

33. Излучательная рекомбинация при двойной инжекции в n^+i -n-гетеропереходах GaAs – $Ga_{1-x}Al_xAs$ / соавт. Ф. П. Тимохов // УФЖ. – 1977. – Т. 22, № 7. – С. 1111–1117.

1978

34. Влияние структуры светоизлучающих диодов на их деградацию / соавт.: В. М. Баранов [и др.] // Тезисы докладов Четвертого Всесоюзного совещания по исследованию арсенида галлия. – Томск, 1978. – С. 32.

35. Движение примесных центров при комнатной температуре в р-n-переходах на основе GaAs, $Ga_{1-x}Al_xAs$, $GaAs_{1-x}P_x$. / соавт.: Л. Ф. Литовченко, В. А. Тепляков, В. М. Баранов // УФЖ. – 1978. – Т. 23, № 1. – С. 100–108.

36. Лавинное умножение носителей заряда в изотипных n^+v - n -гетеропереходах GaAs – Ga_{1-x}Al_xAs / соавт. Ф. П. Тимохов // Изв. вузов. Физика. – 1978. – № 6. – С. 80–84.

37. Механизмы деградации полупроводниковых излучателей оптического диапазона // Тезисы докладов Четвертого Всесоюзного совещания по исследованию арсенида галлия. – Томск, 1978. – С. 27–28.

38. Особенности характеристик фото- и электролюминесценции многослойных полупроводниковых структур / соавт.: В. П. Сушков [и др.] // Электрон. техника. – 1978. – № 8. – С. 37–47. – (Серия 2, Полупроводниковые приборы).

39. Особенности характеристик электролюминесценции n^+v - n -гетероструктур / соавт. Ф. П. Тимохов // УФЖ. – 1978. – Т. 23, № 12. – С. 1989–1993.

40. Перезарядка глубоких примесных уровней в p - v - n -структурах на основе GaAs(о) / соавт. В. И. Марютин // Тезисы докладов Четвертого Всесоюзного совещания по исследованию арсенида галлия. – Томск, 1978. – С. 78.

41. Температурная и временная нестабильность электролюминесценции многослойных полупроводниковых гетероструктур / соавт.: В. П. Сушков [и др.] // Тезисы докладов Второй Всесоюзной конференции по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах. – Ашхабад, 1978. – Т. 1. – С. 77–79.

42. Фотоэлектрические свойства и электролюминесценция изотипных гетероструктур на основе GaAs – Ga_{1-x}Al_xAs / соавт. Ф. П. Тимохов. – Деп. в ВИНТИ 28.02.1978, № 675–678.

1979

43. Влияние оптической обратной связи на характеристики лавинных фотодиодов на основе n^+v - n -гетероструктур // Фотоэлектрические явления в полупроводниках: тез. докл. респ. конф. Ужгород, ноябрь 1979 г. – Киев, 1979. – С. 186–187.

44. Влияние перезарядки примесных ионов на их движение в р-n-переходе // УФЖ. – 1979. – Т. 24, № 9. – С. 1406–1407.
45. Деградация инжекционной электролюминесценции и дрейф примесных ионов в р-n-переходах / соавт.: В. М. Баранов, В. А. Тепляков, Л. Ф. Литовченко // ЖПС. – 1979. – Т. 30, № 4. – С. 751–752. – Деп. в ВИНТИ, рег, 1979, № 468–79.
46. Исследование механизма деградации электролюминесценции $Ga_{1-x}Al_xAs$ / соавт.: В. П. Сушков [и др.] // Письма в ЖТФ. – 1979. – Т. 5, № 10. – С. 624–627.
47. Исследование стабильности излучающих диодов на основе $Ga_{1-x}In_xAs_{1-y}P_y$ / соавт.: В. М. Баранов [и др.] // РЭ. – 1979. – Т. 24, № 11. – С. 2342–2349.
48. Оптическое и термическое гашение инжекционного тока в р-v-n-структурах на основе $GaAs(O)$ / соавт. В. И. Марютин // Фотозлектрические явления в полупроводниках : тез. докл. респ. конф. Ужгород, ноябрь 1979 г. – Киев, 1979. – С. 187–188.
49. Особенности деградации оптических излучателей на основе n^+i -n-гетероструктур $GaAs - Ga_{1-y}Al_yAs - Ga_{1-x}Al_xAs$ / соавт. Ф. П. Тимохов // ЖПС. – 1979. – Т. 31, № 3. – С. 453–454.

1980

50. Деградация светоизлучающих диодов // ЖПС. – 1980. – Т. 33, № 5. – С. 781–803.
51. Исследование глубоких примесных уровней в р-v-n-структурах на основе $GaAs(O)$ / соавт. В. И. Марютин // II Всесоюзное совещание по глубоким уровням в полупроводниках : тез. докл. – Ташкент, 1980. – Ч. 2. – С. 104–105.
52. О механизме насыщения инжекционного тока и отрицательной фотопроводимости р-v-n-структур на основе $GaAs(O)$ / соавт. В. И. Марютин // ФТП. – 1980. – Т. 14, № 1. – С. 3–6.
53. Особенности деградации излучающих диодов, связанные с неоднородностями р-n-переходов / соавт.: В. М. Баранов [и др.] // Оптические системы и элементы оптико-электронной аппаратуры для исследования быстропротекающих процессов. – Москва, 1980. – С. 93–97.

54. Роль дрейфа безызлучательных центров в деградации оптических излучателей на основе GaInAsP и GaAlAs / соавт.: В. М. Баранов [и др.] // Оптические системы и элементы оптико-электронной аппаратуры для исследования быстротекущих процессов. – Москва, 1980. – С. 103–107.

1981

55. Особенности генерации дефектов в GaAs и GaAlAs под действием рентгеновского излучения / соавт. В. И. Ирха // УФЖ. – 1981. – Т. 26, № 11. – С. 1880–1883.

56. Особенности инжекционного отжига дефектов, введенных γ -облучением, в многослойных полупроводниковых излучающих структурах / соавт. В. И. Ирха // Интеграция и нетермическая стимуляция технологических процессов микроэлектроники : тез. докл. Всесоюз. конф. АПМ–81. – Москва, 1981. – С. 96.

57. Особенности радиационной деградации светоизлучающих диодов с переизлучением фотонов / соавт.: В. П. Сушков, В. И. Ирха // ФТП. – 1981. – Т. 15, № 11. – С. 2198. – Деп. в ЦНИИ «Электроника» 27.01.81, № РА–3122.

58. Роль неоднородности р-п-переходов в деградации излучающих диодов на основе InGaAsP / соавт.: В. М. Баранов [и др.] // ЖПС. – 1981. – Т. 35, № 2. – С. 338–343.

1982

59. Влияние дислокаций на эффективность и стабильность элементов оптоэлектроники / соавт. Н. В. Мороз // Первая Всесоюзная конференция «Физические основы надежности и деградации полупроводниковых приборов» : тез. докл. – Кишинев, 1982. – Ч. 1. – С. 50.

60. Высокая магниточувствительность и локализация электрического поля в р-и-п-структурах на основе GaAs(O) / соавт. В. И. Марютин // Пятое Всесоюзное совещание по исследованию арсенида галлия. Томск, 21-23 сент. 1982 г. : тез. докл. – Томск, 1982. – С. 147–149.

61. Деградация p-v-n-светодиодов на основе GaAs(O) / соавт. В. И. Марютин // ЖПС. – 1982. – Т. 36, № 2. – С. 317–319.

62. Исследование деградации оптоэлектронных структур на основе полупроводников A^3B^5 / соавт. В. А. Преснов // Первая Всесоюзная конференция «Физические основы надежности и деградации полупроводниковых приборов»: тез. докл. – Кишинев, 1982. – Ч. 1. – С. 28–29.

63. Кинетика перезарядки примесных уровней в s-диодах на основе GaAs(O) / соавт. В. И. Марютин // ФТП. – 1982. – Т. 16, № 5. – С. 878–880.

64. Особенности микроплазменных явлений в n-v-n-гетероструктурах // Тезисы докладов III Всесоюзной конференции по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах. Одесса, 7-9 июня 1982 г. – Одесса, 1982. – Т. 1. – С. 209–211.

65. Фотоэлектрические свойства p-i-n-структур на основе GaAs(O) / соавт. В. И. Марютин // Фотоэлектрические явления в полупроводниках: тез. докл. II Респ. конф. Одесса, сент. 1982. – Киев, 1982. – С. 195–196.

66. Характеристики туннельно-термических токов в p-n-переходах // УФЖ. – 1982. – Т. 27, № 12. – С. 1829–1833.

1983

67. К природе высокой магнитной чувствительности p-i-n-структур на основе GaAs(O) / соавт. В. И. Марютин // ФТП. – 1983. – Т. 17, № 1. – С. 183. – Деп. в ЦНИИ «Электроника», 1982, № Р–3427/82.

68. О механизме прохождения тока в магниточувствительных p-i-n-структурах на основе GaAs(O) / соавт. В. И. Марютин // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. – Киев, 1983. – С. 5–9.

69. Характеристики предпробойного тока в излучающих n^+v-n -гетероструктурах // ФТП. – 1983. – Т. 17, № 11. – Деп. в ЦНИИ «Электроника», 1983, № Р–3672/83.

1984

70. Влияние механических напряжений на поверхностные свойства арсенида галлия / соавт. Эм Рен Сик // Физика поверхностных явлений в полупроводниках : тез. докл. VIII совещания. – Киев, 1984. – С. 67.

71. Влияние механических напряжений на характеристики диодов с барьером Шоттки на основе GaAs / соавт. Эм Рен Сик // Материалы II Научной конференции молодых ученых Одесского университета им. И. И. Мечникова. Одесса, 29-30 марта 1984 г. – Одесса, 1984. – С. 158–165.

72. Влияние туннельного захвата с испусканием фононов на примесную рекомбинацию носителей заряда в p-n-переходах // УФЖ. – 1984. – Т. 29, № 4. – С. 575–581.

73. Влияние γ -радиации на $Ga_xAl_{1-x}As$ излучающие диоды / соавт.: В. И. Ирха, В. А. Чапнин // Электровакуумные приборы для метрологического обеспечения быстропротекающих процессов. – Москва, 1984. – С. 56–63.

74. Неоднородности распределения фототока по поверхности МДП-структур, подвергнутых длительным механическим напряжениям / соавт. Эм Рен Сик. – Одесса : Одес. гос. ун-т, 1984. – 13 с. : ил. – Деп. в УкрНИИТИ 01.04.85, № 628Ук–85.

1985

75. Деградация СИД на основе GaAlAs в форсированном режиме / соавт.: Б. В. Цап, Н. В. Мороз // Тезисы докладов II Всесоюзной конференции «Моделирование отказов и имитация на ЭВМ статистических испытаний изделий электронной техники». – Москва, 1985. – С. 101–102.

76. Особенности распределения фототока в p-i-n-структурах со сверхдлинной базой на основе компенсированного GaAs, связанные с разогревом электронов / соавт. В. И. Марютин // ФТП. – 1985. – Т. 19, № 12. – С. 2224–2226.

77. Effect of hot electrons trapping on electrical characteristics of p-i-n junctions // Abstracts of 4th International Conference on Hot Electrons in Semiconductors. – Innsbruck, 1985. – P. TU – 4.13.

1986

78. Влияние механических напряжений на деградационные процессы в приборных структурах на основе полупроводников A^3B^5 / соавт. В. А. Преснов // Вторая Всесоюзная конференция «Физические основы надежности и деградации полупроводниковых приборов»: тез. докл. – Кишинев, 1986. – Ч. 1. – С. 14–16.

79. Влияние примесного захвата горячих электронов на электрические свойства p-v-n-структур со сверхдлинной базой на основе квазимонополярного релаксационного полупроводника // ФТП. – 1986. – Т. 20, № 11. – С. 2135. – Деп. в ЦНИИ «Электроника», 1986, Р 4095/86.

80. Деградация электролюминесценции p-n-переходов на основе GaAlAs и GaAsP под действием лазерного облучения / соавт.: Б. В. Цап, Н. В. Мороз // Вторая Всесоюзная конференция «Физические основы надежности и деградации полупроводниковых приборов»: тез. докл. – Кишинев, 1986. – Ч. 1. – С. 58.

81. Захват горячих электронов примесными центрами в полуизолирующем арсениде галлия / соавт. В. И. Марютин // Плазма и неустойчивости в полупроводниках: 6-ой Всесоюз. симп. : тез. докл. – Вильнюс, 1986. – С. 248.

82. Захват горячих электронов примесными центрами в полуизолирующем n-GaAs / соавт. В. И. Марютин // ФТП. – 1986. – Т. 20, № 7. – С. 1205–1208.

83. Общность природы дефектообразования в p-n-переходах на основе GaAlAs и GaAsP при лазерном и ионном облучении и при пропускании прямого тока / соавт.: Б. В. Цап [и др.] // Моделирование на ЭВМ структурночувствительных свойств кристаллических материалов. – Ленинград, 1986. – С. 103–104.

84. О роли дислокаций в деградации светодиодов / соавт. Н. В. Мороз // ЖПС. – 1986. – Т. 45, № 3. – С. 474–478.

1987

85. «Залечивание» неоднородностей р-п-переходов в светодиодах при пропускании обратного тока / соавт.: В. С. Абрамов, Н. Н. Голембиевский, В. П. Сушков // Электрон. техника. – 1987. – № 4. – С. 16–19. – (Серия 2, Полупроводниковые приборы).

86. Нестабильность светодиодов при высоких уровнях инжекции / соавт.: Б. В. Цап, В. Н. Кудашов // Оптоэлектронные методы и средства обработки изображений : материалы Второй Всесоюз. науч.-техн. конф. по функцион. оптоэлектронике. – Винница ; Тбилиси, 1987. – С. 410–412.

87. Природа безызлучательных токов в светодиодах / соавт.: Н. В. Мороз, Б. В. Цап // Оптоэлектронные методы и средства обработки изображений : материалы Второй Всесоюз. науч.-техн. конф. по функцион. оптоэлектронике. – Винница ; Тбилиси, 1987. – С. 417–420.

88. Роль дислокаций в лазерной деградации р-п-переходов на основе GaAlAs и GaAsP / соавт.: Б. В. Цап, Н. В. Мороз // Фотоэлектроника. – 1987. – № 1. – С. 27–31.

1988

89. Влияние малых доз γ -облучения на характеристики р-п-переходов на основе GaAlAs с дислокациями / соавт.: Н. В. Мороз, Л. Ф. Калиниченко. – Одесса : Одес. гос. ун-т, 1988. – 21 с. : ил. – Деп. в УкрНИИТИ 11.08.88, № 1927–Ук88.

1989

90. Влияние варизонности и слоистых неоднородностей на фотоэлектрические свойства гетероструктур на основе GaAsP / соавт. М. Фусик. – Одесса : Одес. гос. ун-т, 1989. – 11 с. : ил. – Деп. в УкрНИИТИ 5.12.89, № 2771–Ук89.

91. Влияние дефектов, вводимых при лазерном ультрафиолетовом облучении, на характеристики оптоэлектронных элементов на основе полупроводников A^3B^5 / соавт. Б. В. Цап // I Всесоюзная конференция по физическим основам твердотельной электроники. Ленинград, 25-29 сент. 1989 г. : тез. докл. – Ленинград, 1989. – Т. В. – С. 299–300.

92. Влияние ионного облучения на фотоэлектрические свойства и электролюминесценцию р-п-гетеропереходов на основе GaAs_{1-x}P_x / соавт. М. Фусик. – Одесса : Одес. гос. ун-т, 1989. – 20 с. : ил. – Деп. в УкрНИИТИ 5.12.89, № 2770–Ук89.

93. Деградация излучающих р-п-переходов / соавт.: Н. В. Мороз, Б. В. Цап // Обеспечение качества и надежности РЭА и ЭВА. – Москва, 1989. – С. 62–79.

94. Деградация р-п-переходов на основе GaAsP и GaAlAs под действием лазерного излучения / соавт. Б. В. Цап // ЖПС. – 1989. – Т. 50, № 6. – С. 897–901.

95. Методика фотоэлектрического контроля неоднородностей полупроводниковых структур / соавт.: Б. В. Цап, Л. П. Прокопович, Н. В. Мороз // Оптический, радиоволновой и тепловой методы неразрушающего контроля : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. Могилев, 23-25 1989 г. – Могилев, 1989. – Ч. 2. – С. 6.

96. Особенности фотоэлектрических свойств р-п-гетеропереходов с неоднородностями / соавт.: Б. В. Цап, Л. П. Прокопович, Н. В. Мороз // Фотоэлектрические явления в полупроводниках : тез. докл. Всесоюз. науч. конф. Ташкент, 24-26 окт. 1989 г. – Ташкент, 1989. – С. 298–299.

97. Роль дислокаций в деградации структур металл – GaAs / соавт. Эм Рен Сик // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. – 1989. – Вып. 16. – С. 33–36.

98. Установка для фотоэлектрического контроля неоднородностей полупроводниковых структур / соавт.: Б. В. Цап, Л. П. Прокопович // Оптико-электронные измерительные устройства и системы : тез. докл. Всесоюз. конф. – Томск, 1989. – Ч. 1. – С. 44.

1990

99. Влияние импульсного лазерного отжига на свойства приповерхностного слоя в GaAlAs и GaAsP / соавт. Б. В. Цап // VI Республиканская конференция «Физические проблемы МДП-интегральной электроники». Севастополь, июнь 1990 г. : тез. докл. – Киев, 1990. – С. 152.

100. Механические напряжения и деградация приборных структур на основе полупроводников A^3B^5 / соавт. Н. В. Мороз // Шумовые и деградационные процессы в полупроводниковых приборах : тез. докл. науч.-техн. семинара. Черногловка, 12-16 нояб. 1990 г. – Москва, 1990. – Ч. 2. – С. 9–10.

101. Отрицательное сопротивление р-п-гетеропереходов с глубокими уровнями / соавт.: Н. В. Мороз, В. И. Будулак // XII Всесоюзная конференция по физике полупроводников. Киев, 23-25 окт. 1990 г. : тез. докл. – Киев, 1990. – Ч. 2. – С. 156–157.

102. Природа «рекомбинационного» тока в р-п-переходах с неоднородностями / соавт.: Н. В. Мороз, Н. М. Ноах // ФТП. – 1990. – Т. 24, № 10. – С. 1990.

103. Статистические закономерности деградации светодиодов на основе $GaAs_{0,6}P_{0,4}$ и $GaP:N$ при импульсных режимах питания / соавт.: В. С. Абрамов [и др.] // Электрон. техника. – 1990. – № 4. – С. 83–87. – (Серия 2, Полупроводниковые приборы).

1991

104. Влияние дислокаций на рекомбинационные процессы в активных слоях полупроводниковых излучателей / соавт.: Н. В. Мороз, Д. В. Мелконян, Н. М. Ноах // Третья Всесоюзная конференция «Физические основы надежности и деградации полупроводниковых приборов». Кишинев, 27-29 мая 1991 г. : тез. докл. – Кишинев, 1991. – Ч. 1. – С. 134.

105. Деградационные процессы, стимулированные механическими напряжениями, в приборных структурах на основе полупроводников A^3B^5 // Третья Всесоюзная конференция «Физические основы надежности и деградации полупроводниковых приборов». Кишинев, 27-29 мая 1991 г. : тез. докл. – Кишинев, 1991. – Ч. 1. – С. 11–12.

106. Механические напряжения в светодиодах и поляризация электролюминесценции / соавт.: Н. В. Мороз, Л. П. Прокопович, М. В. Дейч // Третья Всесоюзная конференция «Физические основы надежности и деградации полупроводниковых приборов». Кишинев, 27-29 мая 1991 г. : тез. докл. – Кишинев, 1991. – Ч. 1. – С. 133.

107. Неоднородности фоточувствительности многоэлементных р-і-п-фотодиодов / соавт.: Л. П. Прокопович, Н. В. Мороз, Л. А. Зехов // Фотозлектрические явления в полупроводниках. Ашхабад, 23-25 окт. 1991 г. : тез. докл. II науч. конф. – Ашхабад, 1991. – С. 339–340.

108. Нестабильности обратных токов многоэлементных р-і-п-фотодиодов / соавт. Л. П. Прокопович, Н. В. Мороз, И. В. Рыжиков // Третье Всесоюзное совещание «Физические основы деградации и надежности полупроводниковых приборов». Москва, 30 сент.-3 окт. 1991 г. : тез. докл. – Москва, 1991. – С. 26–27.

109. О возможном механизме появления отрицательного сопротивления р-п-гетеропереходов с глубокими уровнями / соавт.: Н. В. Мороз, В. И. Будулак // ФТП. – 1991. – Т. 25, № 6. – С. 1018–1021.

110. Фотозлектрические свойства р-п-переходов на основе GaAsP / соавт. М. И. Фусик // Фотозлектроника. – 1991. – № 4. – С. 35–40.

1992

111. Влияние дислокаций на характеристики светодиодов при высоких уровнях инжекции / соавт.: Н. В. Мороз, Д. В. Мелконян // Физические основы надежности и деградации полупроводниковых приборов. Нижний Новгород – Астрахань, сент. 1992 г. : тез. докл. – Нижний Новгород ; Астрахань, 1992. – С. 39.

112. Поляризация подпорогового излучения и механические напряжения в активной области лазерных диодов / соавт.: М. В. Дейч, Л. П. Прокопович, Ф. А. Птащенко // Физические основы надежности и деградации полупроводниковых приборов. Нижний Новгород – Астрахань, сент. 1992 г. : тез. докл. – Нижний Новгород ; Астрахань, 1992. – С. 46.

113. Нестабильность обратных токов и “залечивание” неоднородностей кремниевых р-п-переходов / соавт. Н. В. Мороз, Д. П. Савин, В. З. Лубяный // Физические основы надежности и деградации полупроводниковых приборов. Нижний Новгород – Астрахань, сент. 1992 г. : тез. докл. – Нижний Новгород ; Астрахань, 1992. – С. 66.

114. Роль механических напряжений и дислокаций в деградиационных процессах в полупроводниковых структурах // Физические основы надежности и деградации полупроводниковых приборов. Нижний Новгород – Астрахань, сент. 1992 г.: тез. докл. – Нижний Новгород ; Астрахань, 1992. – С. 38.

115. Polarization of the subthreshold radiation of semiconductor lasers / co-auth.: L. P. Prokopovich, M. V. Deych, F. A. Ptashchenko // Proceedings of the Internatonal Conference on Microelectronics and Computer Science. Kishinew, Moldova, 21-23 Oct. 1992 y. – Kishinew, 1992. – Vol. 1 : Microelectronics. – P. 68–70.

116. Recombination of the minority carriers on dislocations in III–V semiconductors / co-auth.: N. V. Moroz, J. W. Melkonyan // 12th General Conference of the Condensed Matter Division of the E. P. S. Praha, 6-9 April 1992 y.: abstracts. – Praha, 1992. – Vol. 16A. – P. 315.

1993

117. Неоднородности фототока в тонкопленочных р-п-структурах / соавт.: Л. П. Прокопович, Л. А. Зехов // Физика и технология тонких пленок: материалы Четвертой Междунар. конф. – Ивано-Франковск, 1993. – Ч. 2. – С. 324.

118. Polarization of the subthreshold emission and diagnostic of mechanical strain in semiconductor lasers and light-emitting diodes / co-auth.: L. P. Prokopovich, M. V. Deych // Proc. of SPIE. – 1993. – Vol. 2113. – P. 216–222.

119. Tunnel recombination through multilevel centres in barrier semiconductor structures / co-auth. N. V. Moroz // Verhandlungen der Deutschen physikalischen Gesellschaft. – 1993. – Vol. 17A, № 5.– P. 1410.

1994

120. Polarization of the spontaneous radiation of stressed laser heterostructures / co-auth.: M. V. Deych, N. V. Mironchenko, F. A. Ptashchenko // Solid-State Electronics. – 1994. – Vol. 37, № 4/6. – P. 1255–1258.

1995

- 121.** Моделирование фотоэлектрических неоднородностей в пленочных полупроводниковых структурах / соавт. Л. А. Зехов // Физика и технология тонких пленок : материалы Пятой Междунар. конф. – Ивано-Франковск, 1995. – Ч. 1. – С.169.
- 122.** Неоднородности фототока в кремниевых солнечных элементах / соавт. Л. А. Зехов. – Одесса : Одес. гос. ун-т, 1995. – 15 с. : ил. – Деп. в ГНТБ Украины 10.06.95, № 1463–Ук95.
- 123.** Самоорганизация импульсного примесного пробоя пленочных полупроводниковых р-п-структур / соавт. Н. В. Мороз // Физика и технология тонких пленок : материалы Пятой Междунар. конф. – Ивано-Франковск, 1995. – Ч. 2. – С. 188.

1996

- 124.** Модель низкочастотных осцилляций обратного тока р-п-перехода / соавт. Н. В. Мороз. – Одесса, 1996. – 14 с. – Деп. в ГНТБ Украины 01.02.96, № 412–Ук96.
- 125.** Нелинейная физика : основные понятия и идеи : учеб. пособие. – Одесса : Астропринт. – 1996. – 104 с.
- 126.** “Excess” polarization of the spontaneous emission in laser heterostructures / co-auth. F. A. Ptashchenko // Solid-State Electronics. –1996. – Vol. 39, № 10. – P. 1495–1500.
- 127.** Tunnel surface recombination in optoelectronic device modeling / co-auth. F. A. Ptashchenko // Abstracts of the International Conference on Material Science and Material Properties for Infrared Optoelectronics. – Uzhgorod, 1996. – P. 43. – Te same // Proc. of SPIE. – 1997. – Vol. 3182. – P. 145–149.

1997

- 128.** Поляризационные явления в полупроводниковых лазерах с полосковой геометрией / соавт. Ф. А. Птащенко // Тезисы Второго белорусско-российского семинара «Полупроводниковые лазеры и системы на их основе». – Минск, 1997. – С. 12.

129. Effect of local nonradiative recombination on time-resolved electroluminescence of p-n junctions / co-auth.: D. V. Melconyan, N. V. Moroz, F. A. Ptashchenko // *Phys. Status Solidi (A)*. – 1997. – Vol. 159, № 2. – P. 523–534.

130. Polarization effects in stressed AlGaAs laser heterostructures / co-auth. F. A. Ptashchenko // *Abstracts of the First International School and Conference on Polarization Effects in Lasers and Spectroscopy*. – Toronto, 1997. – P. TU.2:45.

1998

131. Астигматизм излучения полупроводниковых лазеров с полосковой геометрией / соавт. Ф. А. Птащенко // *Квантовая электроника : материалы Второй Межгос. науч.-техн. конф.* – Минск, 1998. – С. 85. – Те саме // *ЖПС*. – 2000. – Т. 67, № 4. – С. 461–464.

132. Механічні напруження та деградаційні процеси в лазерних гетероструктурах / співавт. Ф. О. Птащенко // *Фізика і хімія твердих тіл*. – 1998. – № 6. – С. 67–75.

133. Laser heterostructures as optoelectronic sensors / co-auth. F. A. Ptashchenko // *Abstracts of the Workshop «Sensors Springtime in Odesa»*. Odessa, 29-30 May 1998 y. – Odessa, 1998. – P. 14–15. – Те саме рос. мовою // *Тезисы Третьего белорусско-российского семинара «Полупроводниковые лазеры и системы на их основе»*. – Минск, 1999. – С. 54–55 ; те саме укр. мовою // *Вісн. Черкас. держ. технол. ун-ту*. – 2005. – № 3. – С. 241–243.

1999

134. Тонкая структура углового распределения излучения полупроводниковых лазеров / соавт. Ф. А. Птащенко // *Фотоэлектроника*. – 1999. – № 8. – С. 6–12.

2000

135. Влияние окружающей атмосферы на поверхностный ток в р-n-гетероструктурах на основе GaAs-AlGaAs / соавт.: Е. С. Артеменко, Н. В. Маслеева, Ф. А. Птащенко // *Вісн. ОДУ*. – 2000. – Т. 5, вип. 3. – С. 185–190. – (Серія : Фізико-математичні науки).

136. Влияние окружающей диэлектрической среды на характеристики полупроводниковых лазеров / соавт.: Ф. А. Птащенко, И. А. Волков, А. Г. Групп // Фотоэлектроника. – 2000. – № 9. – С. 103–107.

137. Mechanical strain and degradation of laser heterostructures / co-auth.: F. A. Ptashchenko, N. V. Maslejeva, G. V. Sadova // Abstracts of the 5th International Conference on Material Science and Material Properties for Infrared Optoelectronics. – Kyiv, 2000. – P. 27. – Те саме // Proceedings of SPIE. – 2000. – Vol. 4355. – P. 79–86.

2001

138. Вплив газового середовища на поверхневий струм в р-п-гетероструктурах на основі GaAs–AlGaAs / співавт.: О. С. Артеменко, Ф. О. Птащенко // Матеріали VIII Міжнародної конференції «Фізика і технологія тонких плівок та наносистем». – Івано–Франківськ, 2001. – С. 144. – Те саме // ФХТТ.– 2001. – Т. 2, № 3. – С. 481–485.

139. Вплив парів аміаку на поверхневий струм р-п-структур на основі напівпровідників $A^{III}B^V$ / співавт.: О. С. Артеменко, Н. В. Маслєєва, Ф. О. Птащенко // Вісн. ОДУ. – 2001. – Т. 6, вип. 3. – С. 147–153. – (Серія : Фізико-математичні науки).

140. Дослідження сонячного елемента [Електронний ресурс]: метод. вказівки до лаб. роботи спецпрактикуму з оптоелектроніки. – Одеса, 2001. – 16 с. – Режим доступу: <http://phys.onu.edu.ua/student/4course/8/>

141. Основи нелінійної фізики : навч. посіб. – Одеса : Астропринт, 2001. – 108 с. – Гриф МОН України.

142. Tunnel surface recombination in p-n junctions / co-auth. F. A. Ptashchenko // Матеріали VIII Міжнародної конференції «Фізика і технологія тонких плівок та наносистем». – Івано–Франківськ, 2001. – С. 22–23. – Те саме рос. мовою // Фотоелектроника. – 2001. – № 10. – С. 69–71.

- 143.** Деградація діодних лазерів і просторові характеристики їх випромінювання / співавт. Ф. О. Птащенко // I Українська наукова конференція з фізики напівпровідників : тези доп. – Одеса, 2002. – Т. 1 : Стендові доповіді. – С. 208.
- 144.** Керований термоядерний синтез [Електронний ресурс] : метод. посіб. до курсу лекцій «Проблеми сучасної фізики». – Одеса, 2002. – 36 с. – Режим доступу : <http://phys.onu.edu.ua/files/student/problems.pdf>
- 145.** Короткий українсько-російсько-англійський словник термінів квантової електроніки [Електронний ресурс] : метод. посіб. до курсу лекцій «Нелінійна оптика і квантова електроніка» для студентів 3-го курсу. – Одеса, 2002. – 14 с. – Режим доступу : <http://phys.onu.edu.ua/files/student/slovar.pdf>
- 146.** Проводимость в твердом состоянии и каталитическая активность гексацианоферрат (II)-тиосемикарбазидных комплексов 3d-металлов / соавт.: Т. В. Кокшарова [и др.] // Теорет. и эксперим. химия. – 2002. – Т. 38, № 4. – С. 257–261.
- 147.** Просторово-неоднорідна тунельна рекомбінація в р-п-структурах / співавт. Ф. О. Птащенко // I Українська наукова конференція з фізики напівпровідників : тези доп. – Одеса, 2002. – Т. 1 : Пленарні та усні секційні доповіді. – С. 91.
- 148.** Рекомбінація на поверхні та на дислокаціях в р-п-структурах на основі напівпровідників A^3B^5 // I Українська наукова конференція з фізики напівпровідників : тези доп. – Одеса, 2002. – Т. 1 : Пленарні та усні секційні доповіді. – С. 11.
- 149.** Рефрактометричні характеристики напівпровідникових лазерів / співавт. Ф. О. Птащенко // Фотоелектроніка. – 2002. – № 11. – С. 76–80.
- 150.** Характеристики р-п-структур як газових сенсорів / співавт.: О. С. Артеменко, Ф. О. Птащенко // I Українська наукова конференція з фізики напівпровідників : тези доп. – Одеса, 2002. – Т. 2 : Стендові доповіді. – С. 76.

2003

151. Вплив парів аміаку на поверхневий струм в р-n-переходах на основі напівпровідників A^3B^5 / співавт.: О. С. Артеменко, Ф. О. Птащенко // Журн. фіз. дослідж. – 2003. – Т. 7, № 4. – С. 419–425.

152. Вплив парів аміаку на фотоелектричні явища в р-n-структурах на основі GaAs / співавт.: О. С. Артеменко, Ф. О. Птащенко // Матеріали ІХ Міжнародної конференції «Фізика і технологія тонких плівок та наносистем». – Івано-Франківськ, 2003. – Т. 1. – С. 169–170.

153. Кінетика поверхневого струму, пов'язаного з адсорбцією іонів у р-n-переходах / співавт. О. С. Артеменко // Фотоелектроніка. – 2003. – № 12. – С. 47 – 50.

154. Формування поверхневого провідного каналу в р-n-структурах при адсорбції іонів / співавт. Ф. О. Птащенко // Вісн. ОДУ. – 2003. – Т. 8, вип. 2. – С. 226–233. – (Серія : Фізико-математичні науки).

2004

155. Вплив парів аміаку на морфологію поверхні і поверхневу рекомбінацію в р-n-переходах на основі GaAs та GaP // Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології» : тези доп. – Одеса, 2004. – С. 71.

156. Вплив поверхневої рекомбінації на розподіл носіїв заряду в р-n-переході / співавт. Ф. О. Птащенко // Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології» : тези доп. – Одеса, 2004. – С. 91.

157. Ефект поля в р-n-переході / співавт. Ф. О. Птащенко // ІІ Українська наукова конференція з фізики напівпровідників : тези доп. – Чернівці, 2004. – Т. 2 : Стендові доповіді. – С. 305.

158. Збірник задач з фізичних основ оптоелектроніки та квантової електроніки [Електронний ресурс] : метод. посіб. до курсів лекцій «Нелінійна оптика і квантова електроніка», «Фізичні основи оптоелектроніки» та «Квантова електроніка і оптоелектроніка» для студентів 3 і 4 курсів. – Одеса, 2004. – 22 с. – Режим доступу : <http://phys.onu.edu.ua/files/student/zadachiel.pdf>

159. Модель газового сенсора на р-n-переході / співавт. Ф. О. Птащенко // Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології»: тези доп. – Одеса, 2004. – С. 86.

2005

160. Вплив парів аміаку на характеристики р-n-переходів на основі напівпровідників $A^{III}B^V$ / співавт.: О. С. Артеменко [та ін.] // Матеріали ювілейної X Міжнародної конференції «Фізика і технологія тонких плівок та наносистем». – Івано-Франківськ, 2005. – Т. 1. – С. 147–148.

161. Вплив поверхневого розупорядкованого шару на ефект поля в р-n-переходах на основі GaAs / співавт.: О. С. Артеменко, Ф. О. Птащенко // V Міжнародна школа-конференція «Актуальні проблеми фізики напівпровідників»: тези доп. – Дрогобич, 2005. – С. 213.

162. Просторові характеристики напівпровідникових лазерів зі смужковою геометрією / співавт. Ф. О. Птащенко // Всеукраїнський з'їзд «Фізика в Україні»: тези доп. – Одеса, 2005. – С. 175.

163. Р-n структури на основі напівпровідників $A^{III}B^V$ як сенсори / співавт. Ф. О. Птащенко // Матеріали ювілейної X Міжнародної конференції «Фізика і технологія тонких плівок та наносистем». – Івано-Франківськ, 2005. – Т. 1. – С. 75–76.

164. Effect of ammonia vapors on the surface morphology and surface current in p-n junctions on GaP / co-auth.: O. S. Artemenko [et al.] // Photoelectronics. – 2005. – № 14. – P. 97–100.

2006

165. Квантова електроніка [Електронний ресурс]: метод. посіб. до курсів лекцій «Нелінійна оптика і квантова електроніка» та «Квантова електроніка і оптоелектроніка» для студентів 3 і 4 курсів. – Одеса, 2006. – 228 с. – Режим доступу: <http://phys.onu.edu.ua/files/student/quantumel.pdf>

166. Напівпровідникові лазери як рефрактометричні елементи / співавт. Ф. О. Птащенко // II Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології»: тези доп. – Одеса, 2006. – С. 123.

167. Характеристики напівпровідникових лазерів як рефрактометричних елементів / співавт. Ф. О. Птащенко // Вісн. Черкас. держ. технол. ун-ту. – 2006. – Спецвип. – С. 241–243.

168. Degradation of semiconductor devices: non-destructive diagnostics / co-auth. F. O. Ptashchenko // Вісн. ОНУ. – 2006. – Т. 11, вип. 7. – С. 3–18. – (Серія: Фізико-математичні науки).

169. Р-п-переходи на основі напівпровідників A^3B^5 як селективні газові сенсори / співавт.: О. С. Артеменко [та ін.] // II Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології»: тези доп. – Одеса, 2006. – С. 163.

170. Р-п-переходи як селективні газові сенсори / співавт.: О. С. Артеменко, Н. В. Маслєєва, Ф. О. Птащенко // Вісн. Черкас. держ. технол. ун-ту. – 2006. – Спецвип. – С. 238–240.

171. Р-п-переходы на основе GaAs и других полупроводников $A^{III}B^V$ как газовые сенсоры / соавт. Ф. А. Птащенко // Материалы Девятой конференции «Арсенид галлия и полупроводниковые соединения группы III-V». – Томск, 2006. – С. 496–499.

2007

172. Влияние окружающей атмосферы на характеристики кремниевых р-п-переходов / соавт. Е. В. Емец // Материалы докладов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2007». – Москва, 2007*.

173. Влияние паров аммиака на характеристики кремниевых р-п-переходов / соавт. Е. В. Емец // Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения» 2007 г. и Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2007». – Севастополь, 2007. – С. 146–147.

174. Влияние паров аммиака на характеристики p-n-переходов на основе AlGaAs / соавт. В. В. Шугарова // Материалы докладов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2007». – Москва, 2007*.

175. Вплив навколишньої атмосфери на характеристики p-n-переходів на основі AlGaAs / співавт.: Ф. О. Птащенко, В. В. Шугарова // Матеріали XI Міжнародної конференції «Фізика і технологія тонких плівок та наносистем». – Івано-Франківськ, 2007. – С. 194–195.

176. Вплив парів аміаку на поверхневий струм у p-n-переходах на основі AlGaAs і Si / співавт.: Ф. О. Птащенко, О. В. Ємець, В. В. Шугарова // III Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. Одеса, 17-22 черв. 2007 р. : тези доп. – Одеса, 2007. – С. 112.

177. Кремнієві p-n-переходи як газові сенсори / співавт.: Ф. О. Птащенко, О. В. Ємець // Матеріали XI Міжнародної конференції «Фізика і технологія тонких плівок та наносистем». – Івано-Франківськ, 2007. – С. 41–42.

178. Лазерне охолодження атомів [Електронний ресурс]: метод. посіб. до курсів лекцій «Нелінійна оптика і квантова електроніка», «Квантова електроніка і оптоелектроніка» та «Проблеми сучасної фізики» для студентів 3, 4 і 5 курсів. – Одеса, 2007. – 33 с. – Режим доступу : <http://phys.onu.edu.ua/files/student/lazerohol.pdf>

179. Характеристики p-n-переходов на основе AlGaAs как газовых сенсоров / соавт. В. В. Шугарова // Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения» 2007 г. и Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2007». – Севастополь, 2007. – С. 153–154.

180. Effect of ammonia vapors on the surface current in silicon p-n junctions / co-auth.: F. O. Ptashchenko, O. V. Yemets // Photoelectronics. – 2007. – № 16. – P. 89–93.

2008

181. Влияние атомов серы на характеристики p-n-переходов на основе GaAs / соавт.: В. В. Шугарова [и др.] // Материалы докладов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2008». – Москва ; Санкт-Петербург, 2008*.

182. Влияние паров аммиака на характеристики p-n-переходов на основе InGaN / соавт.: О. А. Блажнова, Ф. А. Птащенко // Материалы докладов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2008». – Москва ; Санкт-Петербург, 2008*.

183. Вплив атомів сірки на характеристики p-n-переходів на основі GaAs як газових сенсорів / співавт.: Ф. О. Птащенко [та ін.] // III Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології» : тези доп. – Одеса, 2008. – С. 187.

184. Характеристики p-n-переходів на основі InGaN як газових сенсорів / співавт.: Ф. О. Птащенко, О. А. Блажнова // III Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології» : тези доп. – Одеса, 2008. – С. 81.

185. Effect of sulphur atoms on surface current in GaAs p-n junctions [Електронний ресурс] / co-auth. F. O. Ptashchenko [et al.] // Photoelectronics. – 2008. – № 17. – Р. 36–39. – Режим доступу: <http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/281>

2009

186. Вплив поверхневого легування атомами сірки на характеристики p-n-переходів на основі напівпровідників A^3B^5 / співавт.: Ф. О. Птащенко, Н. В. Маслєєва, О. В. Богдан // IV Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. Запоріжжя, 15-19 верес. 2009 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2009. – Т. 2. – С. 60.

187. Ефект поля, індукований адсорбційними процесами в р-п-переходах / співавт.: Ф. О. Птащенко, В. В. Шугарова, О. В. Ємець // Матеріали XII Міжнародної конференції «Фізика і технологія тонких плівок та наносистем».– Івано-Франківськ, 2009. – Т. 1. – С. 86–88.

188. Механізми впливу адсорбційних процесів на поверхневий струм в р-п-переходах / співавт.: Ф. О. Птащенко, В. В. Шугарова, О. В. Ємець // IV Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. Запоріжжя, 15-19 верес. 2009 р.: тези доп. – Запоріжжя, 2009. – Т. 2. – С. 62.

189. Механізми чутливості газових сенсорів на основі р-п-переходів / співавт.: Ф. О. Птащенко [та ін.] // Матеріали XII Міжнародної конференції «Фізика і технологія тонких плівок та наносистем». – Івано-Франківськ, 2009. – Т. 2. – С. 353–355.

190. Effect of ambient atmosphere on the surface current in silicon p-n junctions / co-auth.: F. O. Ptashchenko, O. V. Yemets // Photoelectronics. – 2009. – № 18. – P. 28–32.

191. Photoluminescence features of Ag halide nanoparticles formed in porous glass matrix / co-auth.: S. A. Gevelyuk [et al.] // «Porous Glasses – Special Glasses» (9th Intern. Seminar). Wrocław–Szklarska Poręba, 1-5 Sept., 2009 y.: abstracts. – Wrocław, 2009. – P. 40.

192. Porous glasses with CdS inclusions luminescence kinetics peculiarities / co-auth.: I. K. Doicho [et al.] // Photoelectronics. – 2009. – № 18. – P. 43–47.

193. Surface current in GaAs p-n junctions, passivated by sulphur atoms / co-auth.: F. O. Ptashchenko, N. V. Masleyeva, O. V. Bogdan // Photoelectronics. – 2009. – № 18. – P. 115–118.

194. Tunnel surface current in GaAs–AlGaAs p-n junctions, due to ammonia molecules adsorption / co-auth.: F. O. Ptashchenko, V. V. Shugarova // Photoelectronics. – 2009. – № 18. – P. 95–98.

2010

195. Вплив структури р-п-переходів на їх характеристики як газових сенсорів / співавт.: Ф. О. Птащенко, В. В. Шугарова // IV Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології»: тези доп. – Одеса, 2010. – С. 72.

196. Основи квантової електроніки: навч. посіб. – Одеса: Астропринт, 2010. – 392 с. – Гриф МОН України.

197. Оцінка співвідношення між нано- і мікрочастинками AgBr у матрицях шпаристого скла по спектрах фотолюмінесценції / співавт.: С. А. Гевелюк [та ін.] // IV Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології»: тези доп. – Одеса, 2010. – С. 282.

198. Сульфідна активація р-п-переходів на основі GaAs як газових сенсорів / співавт.: Ф. О. Птащенко [та ін.] // IV Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології»: тези доп. – Одеса, 2010. – С. 74.

199. Р-п-переходи на основі InGaN з квантовою ямою як газові сенсори / співавт. Ф. О. Птащенко // IV Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології»: тези доп. – Одеса, 2010. – С. 73.

200. Р-п-переходи на основі Si та AlGaAs як газові сенсори / співавт.: Ф. О. Птащенко, О. В. Ємець, В. В. Шугарова // Вісн. Львів. ун-ту. – 2010. – Вип. 45. – С. 171–176. – (Серія фізична).

2011

201. Вплив поверхневого легування на характеристики кремнієвих р-п-переходів як газових сенсорів / співавт.: Ф. О. Птащенко, Г. В. Довганюк // ФХТТ. – 2011. – Т. 12, № 3. – С. 782–784.

202. Вплив поверхневого легування на чутливість р-п-переходів на основі GaAs як газових сенсорів / співавт.: Ф. О. Птащенко [та ін.] // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики «Еврика–2011»: тези доп. – Львів, 2011. – С. А3.

203. Вплив структури кремнієвих р-n-переходів на їх характеристики як газових сенсорів / співавт.: Ф. О. Птащенко, Г. В. Довганюк // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики «Еврика–2011»: тези доп. – Львів, 2011. – С. А5. – Те саме // СЕМСТ. – 2011. – Т. 2, № 4. – С. 13–19.

204. Механізми підсилення поверхневого струму в р-n-переходах, індукованого адсорбційними процесами / співавт.: Ф. О. Птащенко, Г. В. Довганюк // Збірник тез V Української наукової конференції з фізики напівпровідників. Ужгород, 9-15 жовт. 2011 р. – Ужгород, 2011.– С. 472.

205. Особливості довгочасової еволюції кластерів CdS всередині шпаристого скла після γ -опромінення / співавт.: І. К. Дойчо, С. А. Гевелюк, Е. Ришякевич-Пасек // Збірник тез V Української наукової конференції з фізики напівпровідників. Ужгород, 9-15 жовт. 2011 р. – Ужгород, 2011.– С. 219.

206. Фізичні основи твердотільної електроніки [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Одеса, 2011. – 118 с. – Режим доступу: <http://phys.onu.edu.ua/files/student/3course/1term/physTTE.pdf>

207. Effect of surface doping on the characteristics of silicon p-n junctions as gas sensors / co-auth.: F. O. Ptashchenko, G. V. Dovganyuk // Матеріали XIII Міжнародної конференції «Фізика і технологія тонких плівок та наносистем». – Івано-Франківськ, 2011. – Т. 2. – С. 252.

208. Gas sensors on p-n junctions: problems and prospects / co-auth. F. O. Ptashchenko // Матеріали XIII Міжнародної конференції «Фізика і технологія тонких плівок та наносистем». – Івано-Франківськ, 2011. – Т. 1. – С. 74–75.

209. Negative sensitivity of silicon p-n junctions as gas sensors / co-auth.: F. O. Ptashchenko, G. V. Dovganyuk // Photoelectronics. – 2011. – № 20. – Р. 44–48.

210. Small dose γ -irradiation effect on long-time photoluminescence evolution of CdS clusters in porous glass matrix / co-auth.: V. A. Smytyna [et al.] // Advances in Applied Physics and Materials Science Congress APMAS 2011. Antalya, Turkey, 12-13 May 2011 y. : book of abstr. – Antalya, 2011. – Vol. 1. – P. 484.

2012

211. Вплив парів води і аміаку на пробій р-n-переходів / співавт.: Ф. О. Птащенко [та ін.] // V Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології». Одеса, 4-8 черв. 2012 р. : тези доп. – Одеса, 2012. – С. 81.

212. Вплив поверхневого легування на характеристики р-n-переходів на основі GaAs як газових сенсорів / співавт.: Ф. О. Птащенко, В. Р. Гільмутдінова // V Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології». Одеса, 4-8 черв. 2012 р. : тези доп. – Одеса, 2012. – С. 72. – Те саме // СЕМСТ. – 2013 – Т. 10, № 1. – С. 114–123.

213. Effect of ammonia vapors on the breakdown characteristics of Si and GaAs p-n junctions / co-auth.: F. O. Ptashchenko, V. R. Gilmudtinova, G. V. Dovganyuk // Photoelectronics. – 2012. – № 21. – P. 121–126.

2013

214. Тунельний поверхневий струм в р-n-переходах, індукований адсорбційними процесами / співавт.: Ф. О. Птащенко, В. Р. Гільмутдінова, В. В. Шугарова // Матеріали 6-ї Української наукової конференції з фізики напівпровідників. – Чернівці, 2013. – С. 392–393.

215. The double role of NH₃ molecules in surface doping of Si and GaAs p-n junctions as gas sensors / co-auth.: F. O. Ptashchenko, V. R. Gilmudtinova, G. V. Dovganyuk // Матеріали XIII Міжнародної конференції «Фізика і технологія тонких плівок та наносистем». – Івано-Франківськ, 2013. – С. 61.

216. Tunnel surface current in GaAs p-n junctions induced by ammonia molecules adsorption / co-auth.: F. O. Ptashchenko, V. R. Gilmudtinova // Photoelectronics. – 2013. – № 22. – P. 38–42.

2014

217. Деградація газових сенсорів на основі кремнієвих р-n-переходів / співавт.: Ф. О. Птащенко [та ін.] // VI Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології». Одеса, 28 верес.-3 жовт. 2014 р. : тези доп. – Одеса, 2014. – С. 71.

218. Нестабільність поверхневих центрів у газових сенсорах на основі арсенід-галієвих р-п-переходів / співавт.: Ф. О. Птащенко [та ін.] // VI Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології». Одеса, 28 верес.-3 жовт. 2014 р. : тези доп. – Одеса, 2014. – С. 72.

219. Effect of deep centers on the time-resolved surface current induced by ammonia molecules adsorption in GaAs p-n junctions / co-auth.: F. O. Ptashchenko, V. R. Gilmudtinova // Photoelectronics. – 2014. – № 23. – P. 107–111.

2015

220. Кафедра фізики твердого тіла і твердотільної електроніки на сучасному етапі // Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Історія та сучасність (1865-2015). – Одеса, 2015. – С. 820–821.

221. Effect of surface doping on the gas sensitivity of Si and GaAs p-n junctions / co-auth.: F. O. Ptashchenko [et al.] // Physics and Technology of Thin Films and Nanostructures : materials of XV Intern. conf. – Ivano-Frankivsk, 2015. – P. 245.

222. Si and GaAs nanostructures as chemical sensors / co-auth. F. O. Ptashchenko // Physics and Technology of Thin Films and Nanostructures : materials of XV Intern. conf. – Ivano-Frankivsk, 2015. – P. 44–45.

2016

223. Вплив обробки в розчині Na_2S на поверхневий струм в р-п-переходах на основі GaAs / співавт.: Ф. О. Птащенко [та ін.] // VII Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології». Одеса, 30 трав.-3 черв. 2016 р. : тези доп. – Одеса, 2016. – С. 61.

224. Вплив рівня легування кремнієвих р-п-переходів на їхні характеристики як сенсорів парів аміаку / співавт. Ф. О. Птащенко, В. Р. Гільмутдінова, О. С. Кирничук // VII Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології». Одеса, 30 трав.-3 черв. 2016 р. : тези доп. – Одеса, 2016. – С. 62.

225. Effect of water vapors on the time-resolved surface current induced by ammonia molecules adsorption in GaAs p-n junctions / co-auth.: F. O. Ptashchenko, V. R. Gilmudinova // Photoelectronics. – 2016. – № 25. – P. 126–131.

2017

226. Effect of the doping level on the gas sensitivity of Si p-n junctions / co-auth.: F. O. Ptashchenko, V. R. Gilmudinova, O. S. Kyrnychuk // Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems : materials of XVI Intern. conf. – Ivano-Frankivsk, 2017. – P. 153.

2018

227. Вплив поверхневого легування атомами сірки на характеристики газових сенсорів на основі кремнієвих р-п-переходів / співавт.: Ф. О. Птащенко, О. С. Кирничук // VIII Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології : тези доп. – Одеса, 2018. – С. 47.

228. Вплив рівня легування на газову чутливість кремнієвих р-п-переходів [Електронний ресурс] / співавт.: Ф. О. Птащенко, В. Р. Гільмутдінова, О. С. Кирничук // Журн. нано- та електрон. фізики. – 2018. – Т. 10, № 3. – 03022(бсс). – Режим доступу : https://jnep.sumdu.edu.ua/download/numbers/2018/3/articles/JNEP_03022.pdf

ПУБЛІЦИСТИКА

2001

229. До 85-річчя з дня народження професора В. О. Преснова / співавт. В. І. Солошенко // Вісн. ОДУ. – 2001. – Т. 6, вип. 3. – С. 212–214. – (Серія «Фізика»).

230. Зібралися випускники 1961 року : [на фіз. ф-ті 30 черв. відзначалася сорокова річниця першого випуску студентів фіз. ф-ту (після відділення від фіз.-мат. ф-ту) // Одес. ун-т. – 2001. – Лип.-серп. – С. 1–2 : фот.

231. Меморіальна дошка професору В. О. Преснову : [дошка була відкрита 19 верес.] // Одес. ун-т. – 2001. – Листоп. – С. 2.

2002

232. Правда про кримський похід повстанців-махновців // Чорномор. новини. – 2002. – 30 листоп. – С. 3.

233. Чи збирався Сталін виселити українців до Сибіру? // Чорномор. новини. – 2002. – 8 черв. – С. 2.

2003

234. Одеська «Просвіта» і влада // Думська площа. – 2003. – 18 лип. – С. 10.

235. Правда про ОУН – за матеріалами діаспори // Українознавчі діалоги в наукових дослідженнях та практичній діяльності (до 5-річчя відкриття канадсько-українського бібліотечного центру) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2003. – С. 45–48.

2004

236. Кураж і вибір : [про виставу за п'єсою Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти» в Одес. укр. муз.-драм. театрі ім. В. Василька] // Слово Просвіти. – 2004. – 16-22 груд. – С. 15.

237. Одеська «Просвіта» : проблеми і перспективи : [виступ на II Міжнар. наук.-практ. конф. «Українська національна ідея : минуле, сучасне, майбутнє» (Одеса, 14-16 жовт. 2004 р.)] // Програма II Міжнародної науково-практичної конференції «Українська національна ідея : минуле, сучасне, майбутнє». – Одеса, 2004. – С. 16.

238. У просвітян вистачає роботи : [про основні напрями роботи «Просвіти»] // Думська площа. – 2004. – 27 серп. – С. 2–3.

2005

239. Микола Сльозка : тернистий шлях до театру // Море. – 2005. – № 4 (5). – С. 209–211.

2009

240. Микола Сльозка : картинки з мого дитинства // Одеська хвиля-4 : документи, твори, спогади в'язнів сумління / упоряд. П. Отченашенко [та ін.]. – Одеса, 2009. – С. 102–107.

241. Правду про Степана Бандеру і про ОУН – українській молоді // Галичина. – 2009. – Число 15/16. – С. 167–171.

2016

242. Людей ти вчиш любити... : [про письменника С. Конака] // Чорномор. новини. – 2016. – 27 серп.- С. 5.

243. Чорнобиль : трагедія і знак // Думська площа. – 2002. – 26 квіт. – С. 3 ; Чорномор. новини. – 2016. – 14 квіт. – С. 3.

2017

244. Професор-легенда : 2 груд. сповнюється 100 років від дня народж. проф. В. О. Преснова // Чорномор. новини. – 2017. – 2 груд. – С. 5 : фот.

2018

245. Згадую вчителя : до 80-річчя Валентина Мороза // Одес. вісті. – 2018. – 7 лют. – С. 6.

246. Мрія і заповіді Миколи Сльозки : до 90-річчя від дня народж. видат. майстра сцени // Чорномор. новини. – 2018. – 26-28 квіт. – С. 5, 3 фот.

247. Viktor Oleksiyovich Presnov and his main contribution to physics of semiconductors and electronic technique (to 100-th anniversary of his birthday) // Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. – 2018.– Vol. 21, № 1. – P. 104.

Див. також № 265.

ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ

2001

248. Здрастуй, юність моя // Одес. ун-т. – 2001. – № 7/8. – С. 2.

249. У лісі, над Бугом ; Лісова криниця ; Чумаченьки ; Покинуті бджоли ; Веселий карась // Рідне Прибужжя. – 2001. – 1 груд. (№ 132). – С. 3.

250. Храм і тиран : дума // Чорномор. новини. – 2001. – 11 жовт. – С. 3. – Те саме // Одеська хвиля-2 : документи, твори, спогади в'язнів сумління / упоряд. П. Отченашенко [та ін.]. – Одеса, 2007. – С. 209–211.

2002

251. Батькова кузня ; Балада ; Додому, в Одесу ; Пам'яті Олександра Довженка ; Розстріляні зорі ; Твоя правда ; Веселий карась // Думська площа. – 2002. – 1 берез. – С. 10.

252. Дума про кримський похід повстанців-махновців // Чорномор. новини. – 2002. – 30 листоп. – С. 3 ; Літ. Одеса. – 2005. – № 2 (17). – С. 105–108 ; Чорномор. новини. – 2015. – 12 листоп. – С. 3.

253. Камінь на вершині // Перевал. – 2002. – № 3. – С. 41–42.

254. Новий Навуходносор // Чорномор. новини. – 2002. – 8 черв. – С. 2.

255. Олексі Різниченкові // Думська площа. – 2002. – 1 берез. – С. 10.

256. Поезія рідного краю ; Пегас-трамвай ; Осінній грім любові // Думська площа. – 2002. – 29 листоп. – С. 11.

257. Полин-Зоря // Думська площа. – 2002. – 26 квіт. – С. 3.

258. «Я – українець, і я маю право», або Як світ узнав Степана Бандеру // Чорномор. новини. – 2002. –3 жовт. – С. 3.

2003

259. Варшавський суд Степана Бандери // Українознавчі діалоги в наукових дослідженнях та практичній діяльності (до 5-річчя відкриття канадсько-українського бібліотечного центру) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2003. – С. 45–48. – Те саме // Літ. Одеса. – 2006. - № 1 (20). – С. 67–70 (уривок) ; Галичина. – 2009. – Число 15/16. – С. 170–171.

260. Любов і біль : поезії. – Одеса : Маяк, 2003. – 80 с. – Зміст : Полин-зоря ; Поезія рідного краю ; любов і біль ; У лісі над Бугом ; В зелених Карпатах ; Мої ластівки ; Пегасова криниця ; Мої роздуми-думи.

Поезії збірки сповнені любові до людей, до рідного села, що над річкою Журавкою, і до лісів над Бугом, і до зелених Карпат, і до красуні-Одеси. Автор проймається болем за трагічну долю свого народу. Особливе місце займають думи, що відображують трагічні події нашої історії. Цікавими для читачів будуть і вірші, в яких автор з доброзичливим гумором підмічає деякі сторони поезії ряду одеських поетів.

Про кн. : І фізик, і лірик // Одес. вісті. – 2004. – 15 верес. – С. 1 ; Конак С. Лірика... фізика // Чорномор. новини. – 2004. – 24 лип. – С. 3 ; Різників О. Біль і любов Олександра Птащенко // Думська площа. – 2015. – 20 листоп. – С. 4.

261. Як писати вірші ; Кому що... ; Чудо поезії ; Дзвінок до Музи ; Лідоримки ; Куди піти? : [пародії] // Думська площа. – 2003. – 28 берез. – С. 11.

2004

262. Клятва Івана Мазепи : дума // Літ. Одеса. – 2004. – № 2 (13). – С. 37–40.

263. Ластівки над містом // Думська площа. – 2004. – 20 серп. – С. 10.

2006

264. Найкращій у світі жінці ; Я не знав, що земля цвіте ; Ректор ; Інтерв'ю ; Дзвінок до Музи // Думська площа. – 2006. – 12 трав. – С. 8.

265. Нищені – не знищені / передм. О. Різникова. – Одеса : Астропринт, 2006. – 48 с. – Зміст: Розстріляні зорі ; Новий Навуходоносор ; Полин-зоря ; Клятва Івана Мазепи ; Варшавський суд Степана Бандери ; Дума про кримський похід повстанців-махновців ; Храм і тиран ; Пам'яті Олександра Довженка ; Трагедія людей ; Про автора. – В кн. також ст. : Чи збирався Сталін виселити українців до Сибіру? ; Чорнобиль : трагедія і знак ; Правда про Степана Бандеру і про ОУН ; Правда про кримський похід повстанців-махновців ; Олександр Довженко – великий українець.

Збірка містить поезії та публіцистичні статті, які знайомлять читачів з трагічними сторінками історії України.

2007

266. Дума про Антона Крушельницького // Літ. Одеса. – 2007. – № 4 (27). – С. 68–72.

267. Дума про Яринку // Літ. Одеса. – 2007. – № 3 (26). – С. 79–82 ; Слово жінки. – 2015. – № 4/5. – С. 40–41.

2008

268. Дума про Ніну Строкату // Одеська хвиля-3 : документи, твори, спогади в'язнів сумління / упоряд. П. Отченашенко [та ін.]. – Одеса, 2008. – С. 218–220.

2010

269. Дума про Майдан // Одеська хвиля-5 : документи, твори, спогади в'язнів сумління / упоряд. П. Отченашенко [та ін.]. – Одеса, 2010. – С. 129–131 ; Зона. – 2013. – № 28. – С. 173– 177. – (Поезія).

2011

270. Розстріляні зорі // Шляхами пам'яті: антол. поет. творів, присвяч. пам'яті митців Розстріляного Відродження / ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд. Г. І. Єфімова. – Одеса, 2011. – С. 30.

2013

271. Вклоняюсь Вам : зб. поезій / передм. О. І. Вавілової ; ред. О. С. Різників. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2013. – 28 с. – (Вони родом із університету). – Зміст : Не хлібом єдиним / О. І. Вавілова. Фізика і поезія – життя і любов [біогр. довідка]. Найкращій в світі жінці ; Я не знав, що земля цвіте ; Дзвінок до музи ; Поезія рідного краю ; Чоловікам, чиї жінки – поети ; Посланець неба ; Інтерв'ю ; Лідоримки ; Кому що... ; Ректор ; Петрос і Говерла ; Осінній грім любові ; Дума про Ярину ; Дума про Ніну Строкату.

Поезії присвячені жінкам: пісенно ніжним і привабливим, вродливим і розумним, талановитим і мудрим, слабким і водночас сильним, вільним і жертвним, героїчним і самовідданим, щасливим і нещасним... Є також кілька віршів, де автор з доброю усмішкою пише про чоловіків – вірних лицарів своїх обраниць.

2014

272. Наша Голгофа : думи / вступ. ст. О. С. Різникова. – Одеса : Астропринт, 2014. – 72 с. – Зміст : Клятва Івана Мазепи ; Дума про кримський похід повстанців-махновців ; Дума про трьох братів, трьох селянських синів ; Дума про Антона Крушельницького ; Дума про Ярину ; Храм і тиран ; Варшавський суд Степана Бандери ; Дума про Ніну Строкату ; Дума про студента Миколу Невірного ; Дума про майдан ; Дума про Чорновола.

Думи, представлені у збірці, відображують трагічні долі наших простих людей і наших героїв у вихорі боротьби проти загарбників-чужоземців та більшовицької диктатури.

Про кн. : Баран Є. Думи Олександра Птащенко [Електронний ресурс] // Золота пектораль. – 2015. – 24 листоп. – С. 1–2. – (Критика, рецензії, огляди). – Режим доступу : <http://zolutapektoral.te.ua/evhen-baran-dumy-oleksandra-ptaschenka/> ; Дмитренко М. Становлення жанру // Чорномор. новини. – 2015. –

12 листоп. – С. 3; Кир'ян Н. Оновлення жанру // Слово Просвіти. – 2015. – 23-29 квіт. – С. 7; Манакін В. Потрібна школі книжка // Чорномор. новини. – 2015. – 12 листоп. – С. 3; Павліченко В. Кобзарські думи Олександра Птащенка // Веч. Одеса. – 2015. – 28 мая. – С. 7. – (192 сходинок); Шалак О. Продовження традиції [Електронний ресурс]. – 2015. – 13 листоп. – Режим доступу : <http://www.nspu.com.ua/retsenziji/137-prodovzhennya-traditsiji.html> ; Івашків В. Українські думи двадцять першого століття // Дзвін. – 2016. – № 11/12. – С. 258–260; Укр. літературознавство. – Вип. 81. – С. 254–257.

Те саме. – Друге вид., оновл. і допов. – Київ : Укр. пріоритет, 2018. – 96 с. – В кн. також включені рец. на 1-ше вид. зб.

273. Прости, рідна земле; Моя Журавка; Твоя правда; Поезія рідного краю; Лідоримки; Батькова кузня // Степів мелодії одвічні: поезія, проза, гумор / упоряд.: С. І. Мефодовський, П. Ф. Поліщук. – Одеса, 2014. – С. 248–255.

2015

274. Дума про Надію, або «Дівчина проти імперії зла» // Слово Просвіти. – 2015. – 27 серп. – С. 11 : фот.

275. Дума про Надію Савченко // Відродження. – 6 серп. – С. 5; Свобода. – 4 верес. – С. 17; Чорномор. новини. – 2015. – 6 серп. – С. 3; Укр. слово. – 2016. – 17-23 лют. – С. 11.

276. Дума про Надію Савченко [Електронний ресурс] // Укр. погляд. – 2015. – 4 серп. – Режим доступу : <http://ukrpohliad.org/komentari/duma-pro-nadiyu-savchenko.html>.

277. Дума про трьох братів, трьох селянських синів // Чорномор. новини. – 2015. – 22 серп. – С. 5.

278. Любов і ненависть; Твоя правда; Пам'яті Олександра Довженка; Батькова кузня; Я не знав, що земля цвіте; Поезія рідного краю; Посланець неба; Прости, рідна земле // Думська площа. – 2015. – 27 листоп. – С. 6.

2016

279. Людей ти вчиш любити... // Чорномор. новини. – 2016. – 27 серп. – С. 5.

2017

280. Дума про Чорновола // Чорномор. новини. – 2017. – 27-28 груд. – С. 3.

2018

281. Валентинки-морозинки : Осінній грім любові ; Остання стріла Амура ; «Ми листуємося з лісом» // Чорномор. новини. – 2018. – 1 лют. – С. 3.

282. Дума про іловайську дитину // Відродження. – 2018. – 30 серп. – С. 12.

Вибрані поезії

Батькова кузня

Ллються, в'ються

І сміються

Дзеньки-бреньки.

Григорій Чупринка

Дзеньки-бреньки,
дзінь-дзеленьки –
Молоточки і обценьки.
Молот гупа, молот лупа,
А вугілля в горні купа
Гріє сталь – гуде, тріщить,
Синім полум'ям сичить;
І – ах-хи, ох-хи, ух-хи
Жару піддають міхи.

Батько дзенькне молоточком,
А за ним – в ту саму точку
Молот бухає: бу-бух –
У сокири є обух!

Батько лиш кивне до Гриця –
Гриць обценьками – за крицю
Та – в водицю, та – в водицю –
Хай же криця причаститься!

Ой – робота, ой – краса!
Тут – сокира, там – коса,
Тут – граблі, там – борона
І відерце для зерна...
А творять скарби оті
Батька руки золоті.

20 січня 2002 р.

Камінь на вершині

В Карпатах зелених, в гуцульськiм краю,
Де Прут прорiзає мiжгiр'я
І силу могутню плекає свою,
Існує прадавнє повір'я:

Як маєш у серці ти мрію палку
Або потаємне бажання,
То камінь знеси на вершину гірську
Й на нiм напиши заклинання.

І зразу ж помножиться сила твоя,
Й здолаєш ти будь-які гори,
І усміхнеться до тебе земля,
І обмине тебе горе...

Зiбрались і ми на вершину зійти:
В долину прийшли до світання,
Взяли камінці (щоб не важко нести)
І загадали бажання.

Ми дерлись по схилу, ми падали з ніг
(А вітер свистів нам у спину),
І каменепади підступні, і сніг
Здолали й зійшли на вершину.

На купу каміння і наші лягли
Камінчики скромні й легенькі.
А то ж не каміння – то мрії були,
Але все дрібні і сіренькі.

А поруч лежала, як в небі пливла,
Могутня, стотонная брила.
Яка ж ото мрія у когось була!
І де ж то взялась така сила!

25 травня 2001 р.

Моя Журавка

Душею приріс я до міста,
Та сниться ночами село:
Як біло-зелене намисто,
По річці воно потекло.
Ось батьківська хата зринає
І тане в вечірній імлі...
Ніде в цілім світі немає
Миліше і краще землі.
Журавка – чарівнеє слово,
З дитинства так любе мені.
Це – юність моя веселкова,
Це – мрії мої весняні...
І степу цвітіння буяє,
І кличуть в політ журавлі...
Ніде в цілім світі немає
Миліше і краще землі.

Мій друже єдиний, мій брате,
Поїдьмо в село навесні:
Почуєш, як треба співати
Прості українські пісні:
До самого неба злітає
Та пісня на срібнім крилі...
Ніде в цілім світі немає
Миліше і краще землі.

Найкращій в світі жінці

*Вірю: кожній жінці
Бог створив чоловіка,
для якого вона –
найкраща в світі.*

Наснились мені коси твої житні
І посмішка, що збурює серця,
Очей твоїх дві зірочки блакитні
І невловима лінія лиця.

І голос: то дзвенить струмок в пустелі,
То в морі грають хвилі весняні,
А то – бринить струна віолончелі,
То жайворонок б'ється в вишині...

Я так шукав Єдину Жінку в світі
(а дні летять – без ліку, без числа!)...
І раптом – ти – із сонця і блакиті –
Весну у спрагле серце принесла!

Весна прийшла, завітчана барвінком, –
Надій крилатих осяйна пора...
Вклоняюсь Вам, найкраща в світі жінко,
Вам – ангелу Любові і Добра.

Пам'яті Олександра Довженка

Сонет

*Я видів сон. У полі жито золоте, скільки око
гляне. І небо таке синє, таке барвисте,
якого ніколи в світі не буває в житті.
А коли й буває, а коли й здається, то хіба
в надзвичайні часи. А було небо і степ України.*

О. П. Довженко

О літописцю, генію України!
Твій голос чистий на весь світ дзвенів,
Уславив ти і золото ланів,
Й небес блакить Святої Батьківщини.

Ти серцем зігрівав її руїни,
Коли, серед пожарищ і вогнів,
Молох війни зжирав її синів
І чоботом топтав лице країни.

Та кожному пророку – своя доля:
Кому Голгофа, а кому – неволя,
Тобі ж дісталась клітка золота...

Спливли відпущені тобі літа,
Та не зів'яли виплекані квіти.
Тирану – тліть. Поету – вічно жити.

Січень 2001 р.

Полин-зоря

10. І третій ангел посурмив, і впала з неба зоря велика, що палала як смолоскип, і впала на третину річок і на джерела вод.

11. Ім'я зорі тій – Полин. І стала третина вод полином, і багато людей померло від вод, бо прогіркли.

Одкровення від Івана Богослова, Р. 8.

Підсудний і суддя... Ступаю навмання.
Очей – десятки: всі, до мене всі прикуті.
Так важко говорити! Лекція моя –
«Чорнобиль. Як це сталось? Як це могло бути?»

А що сказати? Що ангел третій просурмив
І що Полин-Зоря з небес на землю впала?
Що тисячі людей вогонь її спалив?
І що та мить навіпіл століття розірвала?

Що смертоносне лихо відвернуть могли:
Реактора болячки вже були відомі?
Спитають: «А чому ж **тоді** мовчали ви?
Чи ви ж – не хазяї у своїм власнім домі?

Дожилися, що смерть уранова стоїть
Над Києвом Святим і дихає у спину...
Чи вам за нашу землю серце не болить?» –
Які ж ми хазяї?... Поглянь навколо, сину:

Он – Батько наш Дніпро розтерзаний лежить,
І чорним струпом греблі тіло його вкрили...
І уяви собі, ти уяви на мить,
Що води дощові одну із них підмили:

І села, і міста змете з лиця землі,
Мільйонами людей гатить буде протоки!..
Так хто ж про це подумав? Люди ми – малі:
Мільйони й зараз мруть – то буде менш мороки!

Чому ж **у нас** горять в забоях шахтарі?
Чому ж **у нас** не в ціль – в людей летять ракети?
Чому ж **у нас** живуть у злиднях ВЧИТЕЛІ?
Чому не про любов – про біль кричать поети?

Ти зрозумів, чому? Даремно слів не трать,
А набирайся сил, ставай скоріш на крила!
ТИ – НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ. Учись хазяйнувать,
Щоб наш народ Полин-Зоря не спопелила!

6 листопада 2001 р.

Розстріляні зорі

*У тридцяті роки 20-го ст.
більшовицьким режимом було
знищено три чверті українських
письменників.*

Подивися, мій друже, на небо, на небо України,
На Чумацький, усіяний золотом, зоряний шлях –
Ти побачиш провалля, обвуглені, чорні руїни
На священних, дарованих Богом, небесних полях,

Глянь: тут сяяло світлом чарівним сузір'я поетів –
Наша гордість і слава, що буде світити у віках, –
Та на місці зірок – лише діри від куль і багнетів
Й безіменні могили в Сибіру і на Соловках.

Мій народе, твій цвіт триста років вандали зривали,
Щоб ти в небо поглянуть не міг, тільки в плузі ходив,

Та на місце полеглих сини твої кращі ставали,
І сузір'я нові ти одвіку так щедро родив.

Я не вірю, що зірку хтось може убить з пістолета,
І напевно, у Бога є місце в раю – для митця,
І яка б не була каламутна й глибокая Лета,
Та зірки прилітають із неба – у наші серця.

6 грудня 2001 р.

Світанок на Росі

Срібний світанок на Росі.
Тихо. Ще сплять Божі гори.
В білім тумані, як в морі,
Хвилі зелені покосів.

Верби проснулись і коси
В струменях миють прозорих...
Сонні стоять осокови,
З віття обтрушують роси.

Тіні пливуть над водою,
Мов зачаровані мрії.
Ніч уже там, за горою,
День ще приходить не сміє.

26 серпня 2003 р.

Трагедія людей

Могутній Хаммурапі ввів закони –
Основи правосуддя між людей –
І до сусідів розіслав загани
Для втілення нових своїх ідей.

Міста горіли і палали села,
Чаділи виноградники й сади,
Великим Плачем повнилась Пустеля
І криком знавіснілої орди...

Пройшли тисячоліття. Вік двадцятий...
Нові тирани правлять на землі,
«Нові порядки» вводять заповзято:
Один – в Берліні, інший – у Кремлі.

І знов горять міста, і знов палають села,
І знову тліють виноградники й сади,
І знов – Великий Плач, кривава знов пустеля,
І знову – крики знавіснілої орди...

22 червня 2001 р.

Дума про кримський похід повстанців-махновців

*Пам'яті героїв Повстанської Армії Нестора Махна,
яка, борючись за здійснення віковичного прагнення
хліборобів до вільної праці на вільній землі, та однак,
не маючи державницької ідеї, як могутній, але
сліпий велетень, металась просторами України
і неодноразово ставала трагічною жертвою
підступної політики більшовиків.*

Ой, у Гуляй-Полі та на вольній волі
не зелені діброви під вітром шуміли, –
то козаки-повстанці у неділю вранці
на дружню раду, на сердешну пораду
ой, іще затемна та до батька Махна прилетіли.

А наш батько Махно – золоте стремено –
та козацької вдачі-породи:
хліборобам – земля під сади і поля, і городи;
робітному же люду – під владу-оруду заводи,
а ловцям-рибакам, як і всім козакам, –
і текучі, й стоячі води.

Та не довго в полях та на сірих волах
хлібороби ту землю орали;
та не довго в містах, у заводах-цехах
вільні люди-майстри майстрували;
та не довго в річках і в глибоких ставках
рибаки вільно рибу ловили,
бо повстанську країну,
нашу бідну Вкраїну
вороги звідусіль обступили.

Врангель із Криму татарського
веде тучі війська царського:
всі полки-загони – золотії погони –
всі бійці – офіцери... Та залізні панцери...

А з північних сторін – то червоні
армії піші і конні:
многії пушки-гармати
та незліченні солдати.

І став батько Махно
побратимів-повстанців питати:
„Ой, чи зможемо ми водночас
та й усіх ворогів воювати?
Чи не краще з червоними нам
у союз-договір та вступати
і на Врангеля спільно в похід вирушати,
землю нашу українську
від царського війська звільняти?”

А хлопці-повстанці отак йому відповідали:
коней вороних
рано-вранці швиденько сідлали
і вітром буремним
на Врангеля військо напали,
мов отару овець,
до Турецького Валу догнали,
а селян-хліборобів
з неволі-наруги звільняли
та до себе у військо козацьке
бійців-добровольців збирали.

Сивашу неприступні солоні болота
і кінна кіннота,
і піша піхота
доріжками-путями,
козацькими стежками,
через темную воду
у ніч-непогоду
пройшли-перетнули з важкими боями
і стали на твердую землю
на кримську ногами.

І шаблі козацькі шалено свистіли-рубали,
вразенькам зненацька,
як сніг той на голову, впали
і духом єдиним
до стін Севастополя гнали,
коней вороних
та й у Чорному морі скупали!

Та як тільки бої
у таврійській землі,
як громи, одгриміли,
раптом більшовики –
комісари-вовки, –
не вбоялись ганьби, –
мов звірі-хижаки,
на махновські штаби,
на повстанські полки
уночі налетіли.

І до батька Махна
лише сотня одна
крізь заслони пробилась-прорвалась,
а козацькі полки
та й навіки-віки
у широких степах,
у густих ковилах
непробудно лежати zostались.

Та не згинула вольная воля!
Вічна слава синам Гуляй-Поля!
Та не згинула наша родина –
буде вічно жива Україна!

25 травня 2002 р.

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ, НАУКОВУ, ТВОРЧУ ТА ГРОМАДСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

- 283.** [Біографічна довідка] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://phys.onu.edu.ua/ru/kafedra-fizyky-tverdoho-tila-i-tverdotoilnoi-elektroniky>
- 284.** [Біографічна довідка] // Свобода. – 2015. – 4 верес. – С. 17.
- 285.** [Біографія О. О. Птащенко] // Укр. слово. – 2016. – № 7 (17-23 лют.). – С. 11.
- 286.** Волощак М. Науковий і поетичний світ професора Птащенко : [коротка біогр. довідка та фрагм. думи «Варшавський суд Степана Бандери»] // Шлях перемоги. – 2002. – 21 серп. – С. 10.
- 287.** Ильченко Ю. И физика, и поэзия – его Парнас : [біогр. довідка] // Профком : спец. вип., присвяч. ювілярам 2010 р. – Одеса, 2010. – С. 27 : фот.
- 288.** Коваленко Н. П. Кафедра физики твердого тела и твердотельной электроники Одесского университета // Очерки развития науки в Одессе. – Одесса, 1995. – С. 59–61.
Про О. О. Птащенко. – С. 60.
- 289.** Любов живе у кожному його слові : [біогр. довідка] // Думська площа. – 2015. – 27 листоп. – С. 6 : фот.
- 290.** Одесский университет, 1865-1990 / отв. ред. И. П. Зелинский. – Киев : Лыбидь, 1991. – 160 с.
Про О. О. Птащенко. – С. 86.
- 291.** Олександр Птащенко : [біогр. нарис] // Степів мелодії одвічні : поезія, проза, гумор. – Одеса, 2014. – С. 248.
- 292.** Птащенко Олександр Олександрович // Випускники Одеського (Новоросійського) університету : енциклопед. слов. / упоряд. та бібліогр. ред.: М. О. Подрезова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова. – Одеса, 2005. – Вип. 1. – С. 168 : портр.

293. Птащенко Олександр Олександрович // Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. слов. – Одеса, 2000. – Т. 2 : А-І. – С. 520–522 : портр. – Те саме // Там само. – 2-ге вид. – Одеса, 2005. – С. 577–579 : портр.

294. Різниченко О. Лірика фізика : [про О. О. Птащенка, зокрема про його творчість] // Рідне Прибужжя. – 2001. – 1 груд. (№ 132). – С. 3.

295. Солошенко В. І. Дослідження фізичних основ матеріалів і структур електронної техніки на кафедрі фізики твердого тіла і твердотільної електроніки // Фізичний факультет Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, 1865-2000 : зб. ст. – Одеса, 2001. – С. 91–100.

Про О. О. Птащенка. – С. 92–94, 98–99 ; фот. : с. 105.



296. Арсеньева Т. «Языковые баталии» – очередная предвыборная спекуляция? : [про виступ О. О. Птащенка 20 квіт. на зустрічі членів НСПУ з представниками інших громадських організацій, присвяченій обговоренню проекту Указу Президента України «Про захист прав громадян на використання російської мови та мов інших національностей України»] // Веч. Одесса. – 2005. – 23 апр.*

297. Жакова Т. О соборной, неделимой : [про виступ О. О. Птащенка 20 січ. в ОДНБ ім. Горького на конференції, присвяченій Дню соборності України] // Веч. Одесса. – 2005. – 22 янв. – С. 1.

298. Іванова Т. Відтворити свою епоху : [про презентацію книг одеських письменників – роману «Рихва часу» Г. Щипківського та збірки оповідань «Іванові зяті» В. Полтавчука ; згадується виступ О. О. Птащенка] // Чорномор. новини. – 2015. – 28 трав. – С. 3.

299. Кашкаєв М. Їдло-33 : [про виступ О. О. Птащенка на презентації кн. письменника О. Різників «Їдло-33 : словник голодомору», яка відбулася 3 груд. в бібліотеці ОНУ] // Одес. ун-т. – 2004. – № 1 (січ.). – С. 3.

- 300.** Кракалія Р. Голова «Просвіти» оприлюднив програму дій : [про виступ О. О. Птащенко в радіопередачі «Прийди до серця, Україно» Одес. держ. радіомовлення] // Чорномор. новини. – 2003. – 22 лют. – С. 3.
- 301.** Мацюк М. Вагома місія «Просвіти» : [про виступ О. О. Птащенко на урочистому зібранні одеських просвітян, присвяченому 135-річчю організації] // Чорномор. новини. – 2003. – 13 груд. – С. 4.
- 302.** «Маюнелла» Олекси Різниківіва [Електронний ресурс] : [про виступ О. Птащенко на презентації повісті «Маюнелла», яка відбулася в ОННБ 25 верес. 2014 р.]. – Режим доступу : http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=1009
- 303.** Михайленко А. Тема урока : «Моя українська мова» : [про виступ О. О. Птащенко перед учнями 6-го класу школи № 84 у дитячо-юнацькій бібліотеці № 45 (Одеса)] // Одес. изв. – 2003. – 19 нояб. – С. 4.
- 304.** Нареклися України вірними синами : [про виступ О. О. Птащенко на урочистих зборах з нагоди 135-річчя «Просвіти»] // Думська площа. – 2003. – 19 груд. – С. 1–2.
- 305.** Перегінчук Т. Комарову – з любов'ю : [про виступ О. О. Птащенко на відкритті меморіальної дошки укр. громад. діячеві М. Комарову] // Слово Просвіти. – 2004. – 27 трав.-2 черв. – С. 10.
- 306.** Подоляк М. Сила друкованого слова : [про виступ О. О. Птащенко на книжковій виставці, присвяченій 135-річчю «Просвіти»] // Думська площа. – 2003. – 19 груд. – С. 8.
- 307.** Суховецький М. «Просвіту» очолив фізик : [про обрання О. О. Птащенко головою одеської обласної «Просвіти» та його програму] // Думська площа. – 2003. – 28 лют. – С. 1–2 : фот.
- 308.** Суховецький М. Просвітяни їдуть у глибинку : [про першу поїздку просвітян під керівництвом О. О. Птащенко до Миколаївського р-ну] // Думська площа. – 2003. – 30 трав. – С. 1.

309. Суховецький М. «Я та моя українська мова» : під таким гаслом проводила у школах Саратовського, Арцизького та Великомихайлівського районів відкриті уроки одеська обласна «Просвіта» : [під керівництвом О. О. Птаценка] // Думська площа. – 2003. – 28 листоп. – С. 1–2.

310. Федченко Л. Меморіальна доска артисту Українського театра : [про виступ О. О. Птаценка 11 груд. на відкритті меморіальної дошки народному артисту України М. Сльозці] // Веч. Одесса. – 2013. – 17 дек. – С. 3.

АВТОРСЬКІ СВДОЦТВА І ПАТЕНТИ

311. А. с. 512670 СССР. Датчик температуры / соавт.: Н. А. Гавриленко, В. П. Сушков. – 25.09.74.

312. А. с. № 664417 СССР. Источник оптического излучения / соавт.: О. Д. Кнаб, С. М. Ковыкин, В. А. Тепляков, Ф. П. Тимохов, В. Д. Фролов. – 29.01.1979.

313 А. с. № 1119560 СССР. Полупроводниковый прибор / соавт. В. И. Марютин. – 15.06.1984.

314. Пат. 2018993 РФ. Способ измерения времени жизни неосновных носителей заряда в активной области светодиода / соавт.: Б. В. Цап, Д. В. Мелконян, Н. В. Мороз ; заявитель и патентообладатель ОГУ им. И. И. Мечникова. – № 4888929/25 ; заявл. 10.12.90 ; опубл. 30.08.1994.

315. Пат. 87430 Україна. Метод виявлення поверхневого пробую в р-п-переходах / співавт.: Ф. О. Птащенко, В. Р. Гільмутдінова, Г. В. Довганюк ; заявник і власник патенту ОНУ ім. І. І. Мечникова. – № и 2013 09328 ; заявл. 25.07.2013 ; опубл. 10.02.2014, Бюл. № 3.

ДИСЕРТАЦІЇ, ЗАХИЩЕНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ О. О. ПТАЩЕНКА

- 316.** Тимохов Ф. П. Электролюминесценция изотипных гетероструктур на основе GaAs и Ga_{1-x}Al_xAs : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10. – Одесса : [б. и.], 1979. – 19 с.
- 317.** Марютин В. И. Исследование электрических, фотоэлектрических и магнитных свойств p-v-n-структур на основе GaAs : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10. – Одесса, 1982. – 154 с. : ил.
- 318.** Ірха В. І. Дослідження деградаційних процесів у світловипромінюючих структурах на основі Ga_{1-x}Al_xAs під дією оптичного, рентгенівського та γ-випромінювання : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10. – Одеса, 1983. – 160 с. : іл.
- 319.** Калиниченко Л. Ф. Деградация инжекционной электролюминесценции GaAs, GaAsP и GaAlAs при низких уровнях инжекции : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10. – Одесса, 1985. – 201 с. : ил.
- 320.** Эм Рен Сик. Деградация структур металл-арсенид галлия : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10. – Одесса, 1985. – 149 с. : ил.
- 321.** Белаль Т. Влияние глубоких уровней на электролюминесценцию p-n-переходов на основе GaAlAs и GaAsP : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10. – Одесса, 1986. – 169 с. : ил.
- 322.** Мороз (Маслєєва) Н. В. Вплив дислокацій на електричні властивості та електролюмінесценцію p-n-переходів на основі GaAlAs та GaAsP : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10. – Одеса, 1986. – 150 с. : іл.
- 323.** Цап Б. В. Деградація p-n-переходів на основі GaAlAs та GaAsP під дією лазерного випромінювання : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10. – Одеса, 1988. – 163 с. : іл.
- 324.** Фусик М. Влияние ионного облучения на рекомбинационные процессы в излучающих p-n-гетеропереходах на основе GaAsP : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10. – Одесса, 1989. – 157 с. : ил.

325. Ноах Н. М. Влияние дислокаций на рекомбинационные процессы в излучающих р-п-переходах на основе СаР : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10. – Одесса, 1991. – 128 с. : ил.

326. Мелконян Д. В. Рекомбинация носителей заряда в воспринимающих р-п-переходах на основе GaP с неоднородностями : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10. – Одесса, 1994. – 16 с. : ил.

327. Артеменко О. С. Вплив адсорбції молекул аміаку на поверхневі явища в р-п-переходах на основі напівпровідників АІІІВV : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10. – Одеса, 2004.

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Астигматизм излучения полупроводниковых лазеров с плосковой геометрией – 131

Влияние атомов серы на характеристики р-n-переходов на основе GaAs – 181

Влияние варизонности и слоистых неоднородностей на фотоэлектрические свойства гетероструктур на основе GaAsP – 90

Влияние величины тока на спектр излучения светодиодов на основе арсенида галлия – 11

Влияние дефектов, вводимых при лазерном ультрафиолетовом облучении, на характеристики оптоэлектронных элементов на основе полупроводников A^3B^5 – 91

Влияние дислокаций на рекомбинационные процессы в активных слоях полупроводниковых излучателей – 104

Влияние дислокаций на характеристики светодиодов при высоких уровнях инжекции – 111

Влияние дислокаций на эффективность и стабильность элементов оптоэлектроники – 59

Влияние избыточных токов на температурное гашение электролюминесценции светодиодов на основе GaAs – 19

Влияние импульсного лазерного отжига на свойства приповерхностного слоя в GaAlAs и GaAsP – 99

Влияние ионного облучения на фотоэлектрические свойства и электролюминесценцию р-n-гетеропереходов на основе $GaAs_{1-x}P_x$ – 92

Влияние малых доз γ -облучения на характеристики р-n-переходов на основе GaAlAs с дислокациями – 89

Влияние механических напряжений на деградационные процессы в приборных структурах на основе полупроводников A^3B^5 – 78

Влияние механических напряжений на поверхностные свойства арсенида галлия – 70

Влияние механических напряжений на характеристики диодов с барьером Шоттки на основе GaAs – 71

Влияние окружающей атмосферы на поверхностный ток в р-n-гетероструктурах на основе GaAs-AlGaAs – 135

Влияние окружающей атмосферы на характеристики кремниевых р-n-переходов – 172

Влияние окружающей диэлектрической среды на характеристики полупроводниковых лазеров – 136

Влияние оптической обратной связи на характеристики лавинных фотодиодов на основе n^+-v-n -гетероструктур – 43

Влияние паров аммиака на характеристики кремниевых p - n -переходов – 173

Влияние паров аммиака на характеристики p - n -переходов на основе $AlGaAs$ – 174

Влияние паров аммиака на характеристики p - n -переходов на основе $InGaN$ – 182

Влияние перезарядки примесных ионов на их движение в p - n -переходе – 44

Влияние примесного захвата горячих электронов на электрические свойства p - v - n -структур со сверхдлинной базой на основе квазимонополярного релаксационного полупроводника – 79

Влияние структуры светоизлучающих диодов на их деградацию – 34

Влияние туннельного захвата с испусканием фононов на примесную рекомбинацию носителей заряда в p - n -переходах – 72

Влияние уменьшения концентрации акцепторов в процессе старения на свойства светодиодов – 17

Влияние γ -радиации на $Ga_xAl_{1-x}As$ излучающие диоды – 73

Вплив атомів сірки на характеристики p - n -переходів на основі $GaAs$ як газових сенсорів – 183

Вплив газового середовища на поверхневий струм в p - n -гетероструктурах на основі $GaAs-AlGaAs$ – 138

Вплив навколишньої атмосфери на характеристики p - n -переходів на основі $AlGaAs$ – 175

Вплив обробки в розчині Na_2S на поверхневий струм в p - n -переходах на основі $GaAs$ – 223

Вплив парів аміаку на морфологію поверхні і поверхневу рекомбінацію в p - n -переходах на основі $GaAs$ та GaP – 155

Вплив парів аміаку на поверхневий струм в p - n -переходах на основі напівпровідників A^3B^5 – 151

Вплив парів аміаку на поверхневий струм у p - n -переходах на основі $AlGaAs$ і Si – 176

Вплив парів аміаку на поверхневий струм p - n -структур на основі напівпровідників $A^{III}B^V$ – 139

Вплив парів аміаку на фотоелектричні явища в p - n -структурах на основі $GaAs$ – 152

Вплив парів аміаку на характеристики p - n -переходів на основі напівпровідників $A^{III}B^V$ – 160

Вплив парів води і аміаку на пробій p - n -переходів – 211

Вплив поверхневого легування атомами сірки на характеристики газових сенсорів на основі кремнієвих р-n-переходів – 227

Вплив поверхневого легування на характеристики р-n-переходів на основі GaAs як газових сенсорів – 212

Вплив поверхневого легування атомами сірки на характеристики р-n-переходів на основі напівпровідників A^3B^5 – 186

Вплив поверхневого легування на характеристики кремнієвих р-n-переходів як газових сенсорів – 201

Вплив поверхневого легування на чутливість р-n-переходів на основі GaAs як газових сенсорів – 202

Вплив поверхневого розупорядкованого шару на ефект поля в р-n-переходах на основі GaAs – 161

Вплив поверхневої рекомбінації на розподіл носіїв заряду в р-n-переході – 156

Вплив рівня легування кремнієвих р-n-переходів на їхні характеристики як сенсорів парів аміаку – 224

Вплив рівня легування на газову чутливість кремнієвих р-n-переходів – 228

Вплив структури кремнієвих р-n-переходів на їх характеристики як газових сенсорів – 203

Вплив структури р-n-переходів на їх характеристики як газових сенсорів – 195

Высокая магниточувствительность и локализация электрического поля в р-i-n-структурах на основе GaAs(O) – 60

Движение примесных центров при комнатной температуре в р-n-переходах на основе GaAs, $Ga_{1-x}Al_xAs$, $GaAs_{1-x}P_x$ – 35

Двойные оптические переходы и антистоксова люминесценция – 22

Двойные оптические переходы через глубокие уровни и спектральное преобразование электромагнитного излучения – 20

Деградационные процессы, стимулированные механическими напряжениями, в приборных структурах на основе полупроводников A^3B^5 – 105

Деградация излучающих р-n-переходов – 93

Деградация излучения GaAs:Si-светодиодов при высоких плотностях тока – 23

Деградация инжекционной электролюминесценции и дрейф примесных ионов в р-n-переходах – 45

Деградация светодиодов на основе $GaAs_{1-x}P_x$ и $Ga_{1-x}Al_xAs$ – 21

Деградация светоизлучающих диодов – 50

Деградация светоизлучающих диодов на основе GaAs, $Ga_{1-x}Al_xAs$ и $GaAs_{1-x}P_x$ и накопление примесных центров в

p-n-переходах – 32

Деградация СИД на основе GaAlAs в форсированном режиме – 75

Деградация электролюминесценции p-n-переходов на основе GaAlAs и GaAsP под действием лазерного облучения – 80

Деградация p-n-переходов на основе GaAsP и GaAlAs под действием лазерного излучения – 94

Деградация p-v-n-светодиодов на основе GaAs(O) – 61

Деградация газовых сенсоров на основе кремниевых p-n-переходов – 217

Деградация диодных лазеров и просторовые характеристики их пропускания – 143

Дослідження сонячного елемента: метод. вказівки до лабораторної роботи спецпрактикуму з оптоелектроніки – 140

Эффект поля в p-n-переходе – 157

Эффект поля, индуцированный адсорбционными процессами в p-n-переходах – 187

«Залечивание» неоднородностей p-n-переходов в светодиодах при пропускании обратного тока – 85

Захват горячих электронов примесными центрами в полуизолирующем арсениде галлия – 81

Захват горячих электронов примесными центрами в полуизолирующем n-GaAs – 82

Збірник задач з фізичних основ оптоелектроніки та квантової електроніки: метод. посіб. до курсів лекцій «Нелінійна оптика і квантова електроніка», «Фізичні основи оптоелектроніки» та «Квантова електроніка і оптоелектроніка» для студентів 3 і 4 курсів – 158

Избыточные токи и старение светодиодов на основе GaAs – 18

Излучательная рекомбинация при двойной инжекции в n⁺-i-n-гетеропереходах GaAs – Ga_{1-x}Al_xAs – 33

ИК-гашение в CdS при различной степени участия r-канала в рекомбинации – 1

Инфракрасное гашение примесной фотопроводимости в сульфиде кадмия – 5

Инфракрасное гашение примесной фотопроводимости сульфида кадмия – 2

Ионная проводимость и нестационарное распределение примесных центров в полупроводниках с p-n-переходом – 25

Исследование глубоких примесных уровней в p-v-n-структурах на основе GaAs (O) – 51

Исследование деградации оптоэлектронных структур на основе полупроводников A³B⁵ – 62

Исследование механизма деградации электролюминесценции $Ga_{1-x}Al_xAs$ – 46

Исследование механизмов деградации светоизлучающих диодов на основе $GaAs_{1-x}P_x$ и $Ga_{1-x}Al_xAs$ при низких уровнях инжекции – 26

Исследование поверхностных токов в p-n-переходах на основе арсенида галлия – 12

Исследование примесной фотопроводимости и ее инфракрасного гашения в полупроводниковых веществах типа CdS – 9

Исследование спектральной зависимости фотоионизации очувствляющих центров в сульфиде кадмия – 6

Исследование стабильности излучающих диодов на основе $Ga_{1-x}In_xAs_{1-y}P_y$ – 47

Исследование старения светодиодов на основе арсенида галлия – 13

Исследование стационарного инфракрасного гашения фототока в CdS – 3

Исследование фотопроводимости $n^+-n-v-n^+$ -гетероструктур $GaAs - Ga_{1-x}Al_xAs - Ga_{1-y}Al_yAs - GaAs$ – 27

Исследование p-i-n структур на основе $GaAs(O)$ – 28

К вопросу об инфракрасном гашении фотопроводимости в монокристаллах CdS – 4

К природе высокой магнитной чувствительности p-i-n-структур на основе $GaAs(O)$ – 67

Кафедра фізики твердого тіла і твердотільної електроніки на сучасному етапі – 220

Квантова електроніка: метод. посіб. до курсів лекцій «Нелінійна оптика і квантова електроніка» та «Квантова електроніка і оптоелектроніка» для студентів 3 і 4 курсів – 165

Керований термоядерний синтез: метод. посіб. до курсу лекцій «Проблеми сучасної фізики» – 144

Кинетика перезарядки примесных уровней в s-диодах на основе $GaAs(O)$ – 63

Кинетика примесной фотопроводимости полупроводников типа CdS – 10

Кінетика поверхневого струму, пов'язаного з адсорбцією іонів у p-n-переходах – 153

Короткий українсько-російсько-англійський словник термінів квантової електроніки: метод. посіб. до курсу лекцій «Нелінійна оптика і квантова електроніка» для студентів 3-го курсу – 145

Кремнієві p-n-переходи як газові сенсори – 177

Лавинное умножение носителей заряда в изотипных

$n^+ - v - n$ -гетеропереходах GaAs – $Ga_{1-x}Al_xAs$ – 36

Лазерне охолодження атомів: метод. посіб. до курсів лекцій «Нелінійна оптика і квантова електроніка», «Квантова електроніка і оптоелектроніка» та «Проблеми сучасної фізики» для студентів 3, 4 і 5 курсів – 178

Методика фотоелектрического контролю неоднородностей полупроводниковых структур – 95

Методы исследования стабильности СИД – 29

Механизмы деградации и прогнозирование срока службы оптоэлектронных устройств на $p - n$ -переходах – 24

Механизмы деградации полупроводниковых излучателей оптического диапазона – 37

Механизмы оптического гашения люминесценции в полупроводниках с несколькими каналами рекомбинации – 30

Механические напряжения в светодиодах и поляризация электролюминесценции – 106

Механические напряжения и деградация приборных структур на основе полупроводников A^3B^5 – 100

Механізми впливу адсорбційних процесів на поверхневий струм в $p - n$ -переходах – 188

Механізми підсилення поверхневого струму в $p - n$ -переходах, індукованого адсорбційними процесами – 204

Механізми чутливості газових сенсорів на основі $p - n$ -переходів – 189

Механічні напруження та деградаційні процеси в лазерних гетероструктурах – 132

Моделирование фотоэлектрических неоднородностей в пленочных полупроводниковых структурах – 121

Модель газового сенсора на $p - n$ -переході – 159

Модель низкочастотных осцилляций обратного тока $p - n$ -перехода – 124

Монополярная инжекция и лавинное умножение носителей заряда в высокоомных слоях полупроводников – 31

Напівпровідникові лазери як рефрактометричні елементи – 166

Нелинейная физика: основные понятия и идеи: учеб. пособие – 125

Неоднородности распределения фототока по поверхности МДП-структур, подвергнутых длительным механическим напряжениям – 74

Неоднородности фототока в кремниевых солнечных элементах – 122

Неоднородности фототока в тонкопленочных $p - n$ -структурах – 117

- Неоднородности фоточувствительности многоэлементных p-i-n-фотодиодов – 107
- Нестабильности обратных токов многоэлементных p-i-n-фотодиодов – 108
- Нестабильность обратных токов и “залечивание” неоднородностей кремниевых p-n-переходов – 113
- Нестабильность светодиодов при высоких уровнях инжекции – 86
- Нестабільність поверхневих центрів у газових сенсорах на основі арсенід-галієвих p-n-переходів – 218
- О возможном механизме появления отрицательного сопротивления p-n-гетеропереходов с глубокими уровнями – 109
- О механизме насыщения инжекционного тока и отрицательной фотопроводимости p-v-n-структур на основе GaAs (O) – 52
- О механизме прохождения тока в магниточувствительных p-i-n-структурах на основе GaAs(O) – 68
- О роли дислокаций в деградации светодиодов – 84
- Общность природы дефектообразования в p-n-переходах на основе GaAlAs и GaAsP при лазерном и ионном облучении и при пропускании прямого тока – 83
- Оптическое и термическое гашение инжекционного тока в p-v-n-структурах на основе GaAs(O) – 48
- Основи квантової електроніки: навч. посіб. – 196
- Основи нелінійної фізики: навч. посіб. – 141
- Особенности генерации дефектов в GaAs и GaAlAs под действием рентгеновского излучения – 55
- Особенности деградации излучающих диодов, связанные с неоднородностями p-n-переходов – 53
- Особенности деградации оптических излучателей на основе n⁺-i-n-гетероструктур GaAs – Ga_{1-y}Al_yAs – Ga_{1-x}Al_xAs – 49
- Особенности инжекционного отжига дефектов, введенных γ-облучением, в многослойных полупроводниковых излучающих структурах – 56
- Особенности микроплазменных явлений в n-v-n-гетероструктурах – 64
- Особенности радиационной деградации светоизлучающих диодов с переизлучением фотонов – 57
- Особенности распределения фототока в p-i-n-структурах со сверхдлинной базой на основе компенсированного GaAs, связанные с разогревом электронов – 76

Особенности стационарных люкс-амперных характеристик примесной фотопроводимости с очувствляющих центров в сернистом кадмии – 7

Особенности фотоэлектрических свойств р-n-гетеропереходов с неоднородностями – 96

Особенности характеристик фото- и электролюминесценции многослойных полупроводниковых структур – 38

Особенности характеристик электролюминесценции n⁺-v-n-гетероструктур – 39

Особливості довгочасової еволюції кластерів CdS всередині шпаристого скла після γ-опромінення – 205

Отрицательное сопротивление р-n-гетеропереходов с глубокими уровнями – 101

Оцінка співвідношення між нано- і мікрочастинками AgBr у матрицях шпаристого скла по спектрах фотолюмінесценції – 197

Перезарядка глубоких примесных уровней в р-v-n-структурах на основе GaAs(o) – 40

Поляризационные явления в полупроводниковых лазерах с полосковой геометрией – 128

Поляризация подпорогового излучения и механические напряжения в активной области лазерных диодов – 112

Природа безызлучательных токов в светодиодах – 87

Природа «рекомбинационного» тока в р-n-переходах с неоднородностями – 102

Проводимость в твердом состоянии и каталитическая активность гексацианоферрат (II)-тиосемикарбазидных комплексов 3d-металлов – 146

Просторові характеристики напівпровідникових лазерів зі смужковою геометрією – 162

Просторово-неоднорідна тунельна рекомбінація в р-n-структурах – 147

Рекомбінація на поверхні та на дислокаціях в р-n-структурах на основі напівпровідників A³B⁵ – 148

Рефрактометричні характеристики напівпровідникових лазерів – 149

Роль дислокаций в деградации структур металл – GaAs – 97

Роль дислокаций в лазерной деградации р-n-переходов на основе GaAlAs и GaAsP – 88

Роль дрейфа безызлучательных центров в деградации оптических излучателей на основе GaInAsP и GaAlAs – 54

Роль механических напряжений и дислокаций в деградационных процессах в полупроводниковых структурах – 114

Роль неоднородности р-n-переходов в деградации излучающих диодов на основе InGaAsP – 58

Роль центров красной люминесценции в процессах фотопроводимости в CdS – 8

Самоорганизация импульсного примесного пробоя пленочных полупроводниковых р-n-структур – 123

Сопоставление различных механизмов деградации светодиодов на основе арсенида галлия – 14

Статистические закономерности деградации светодиодов на основе GaAs_{0,6}P_{0,4} и GaP:N при импульсных режимах питания – 103

Сульфідна активація р-n-переходів на основі GaAs як газових сенсорів – 198

Температурная и временная нестабильность электролюминесценции многослойных полупроводниковых гетероструктур – 41

Температурное гашение электролюминесценции в светодиодах на основе арсенида галлия с примесью цинка – 15

Температурные зависимости избыточных и обратных токов в р-n-переходах на основе арсенида галлия – 16

Тонкая структура углового распределения излучения полупроводниковых лазеров – 134

Тунельний поверхневий струм в р-n-переходах, індукований адсорбційними процесами – 214

Установка для фотоэлектрического контроля неоднородностей полупроводниковых структур – 98

Фізичні основи твердотільної електроніки: навч. посіб. – 206

Формування поверхневого провідного каналу в р-n-структурах при адсорбції іонів – 154

Фотоэлектрические свойства и электролюминесценция изотипных гетероструктур на основе GaAs – Ga_{1-x}Al_xAs – 42

Фотоэлектрические свойства р-i-n-структур на основе GaAs(O) – 65

Фотоэлектрические свойства р-n-переходов на основе GaAsP – 110

Характеристики напівпровідникових лазерів як рефрактометричних елементів – 167

Характеристики предпробойного тока в излучающих n⁺-v-n-гетероструктурах – 69

Характеристики тунельно-термических токов в р-n-переходах – 66

Характеристики р-n-переходів на основі InGaN як газових сенсорів – 184

- Характеристики p-n-переходов на основе AlGaAs как газовых сенсоров – 179
- Характеристики p-n-структур як газових сенсорів – 150
- Degradation of semiconductor devices : non-destructive diagnostics – 168
- Effect of ambient atmosphere on the surface current in silicon p-n junctions – 190
- Effect of ammonia vapors on the breakdown characteristics of Si and GaAs p-n junctions – 213
- Effect of ammonia vapors on the surface current in silicon p-n junctions – 180
- Effect of ammonia vapors on the surface morphology and surface current in p-n junctions on GaP – 164
- Effect of deep centers on the time-resolved surface current induced by ammonia molecules adsorption in GaAs p-n junctions – 219
- Effect of hot electrons trapping on electrical characteristics of p-i-n junctions – 77
- Effect of local nonradiative recombination on time-resolved electroluminescence of p-n junctions – 129
- Effect of sulphur atoms on surface current in GaAs p-n junctions – 185
- Effect of surface doping on the characteristics of silicon p-n junctions as gas sensors – 207
- Effect of surface doping on the gas sensitivity of Si and GaAs p-n junctions – 221
- Effect of the doping level on the gas sensitivity of Si p-n junctions – 226
- Effect of water vapors on the time-resolved surface current induced by ammonia molecules adsorption in GaAs p-n junctions – 225
- “Excess” polarization of the spontaneous emission in laser heterostructures – 126
- Gas sensors on p-n junctions : problems and prospects – 208
- Laser heterostructures as optoelectronic sensors – 133
- Mecanical strain and degradation of laser heterostructures – 137
- Negative sensitivity of silicon p-n junctions as gas sensors – 209
- Photoluminescence features of Ag halide nanoparticles formed in porous glass matrix –191
- P-n-переходи на основі напівпровідників A^3B^5 як селективні газові сенсорі – 169
- P-n-переходи на основі InGaN з квантовою ямою як газові сенсорі – 199
- P-n-переходи на основі Si та AlGaAs як газові сенсорі – 200
- P-n-переходи як селективні газові сенсорі – 170

- P-n-переходы на основе GaAs и других полупроводников A^{III}B^V как газовые сенсоры – 171
- P-n-структури на основі напівпровідників A^{III}B^V як сенсори – 164
- Polarization effects in stressed AlGaAs laser heterostructures – 130
- Polarization of the spontaneous radiation of stressed laser heterostructures –120
- Polarization of the subthreshold emission and diagnostic of mechanical strain in semiconductor lasers and light-emitting diodes – 118
- Polarization of the subthreshold radiation of semiconductor lasers – 115
- Porous glasses with CdS inclusions luminescence kinetics peculiarities – 192
- Recombination of the minority carriers on dislocations in III–V semiconductors – 116
- Si and GaAs nanostructures as chemical sensors – 222
- Small dose γ -irradiation effect on long-time photoluminescence evolution of CdS clusters in porous glass matrix – 210
- Surface current in GaAs p-n junctions, passivated by sulphur atoms – 193
- The double role of NH₃ molecules in surface doping of Si and GaAs p-n junctions as gas sensors – 215
- Tunnel recombination through multilevel centres in barrier semiconductor structures – 119
- Tunnel surface current in GaAs p-n junctions induced by ammonia molecules adsorption – 216
- Tunnel surface current in GaAs–AlGaAs p-n junctions, due to ammonia molecules adsorption – 194
- Tunnel surface recombination in optoelectronic device modeling – 127
- Tunnel surface recombination in p-n junctions – 142

ПОКАЖЧИК ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

Журнали

Вісник Львівського університету	Львів
Вісник Одеського державного університету	Одеса
Вісник Черкаського державного технологічного університету	Черкаси
Вопросы физики твердого тела	Київ
Галичина	Івано-Франківськ
Дзвін	Львів
Доклады Академии наук СССР (ДАН СССР)	Москва (Росія)
Журнал прикладной спектроскопии (ЖПС)	Мінськ (Білорусь)
Журнал фізичних досліджень (Journal of Physics Studies)	Львів
Золота пектораль	Чортків
Зона	Одеса
Известия ВУЗов. Физика	Томськ (Росія)
Літературна Одеса	Одеса
Море	Одеса
Оптоэлектроника и полупроводниковая техника	Київ
Перевал	Івано-Франківськ
Письма в Журнал технической физики (ЖТФ)	Санкт-Петербург (Росія)
Радиотехника и электроника (РЭ)	Москва (Росія)
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології (СЕМСТ)	Одеса
Слово жінки	Київ
Теоретическая и экспериментальная химия	Київ
Українське літературознавство	Львів
Український фізичний журнал (УФЖ) (Ukrainian Journal of Physics (UJP))	Київ
Физика и техника полупроводников (ФТП)	Санкт-Петербург (Росія)
Физика твердого тела (ФТТ)	Санкт-Петербург (Росія)
Фізика і хімія твердого тіла (ФХТТ)	Івано-Франківськ
Фотозлектроника (Photoelectronics)	Одеса
Электронная техника	Фрязіно (Росія)
Physica Status Solidi (A)	Берлін (Німеччина)

Газети

Вечерня Одесса	Одеса
Відродження	Чернівці
Думська площа	Одеса
Одесский университет	Одеса
Одеські вісті = Одесские известия	Одеса
Рідне Прибужжя	Миколаїв
Свобода	Нью-Йорк (США)
Слово Просвіти	Київ
Українське слово	Київ
Український погляд	Київ
Чорноморські новини	Одеса
Шлях перемоги	Київ

ПОКАЖЧИК ІМЕН

- Абрамов В. С. 85, 103
Арсеньєва Т. 296
Артеменко О. С. (Е. С.)
(Artemenko O. S.) 135, 138,
139, 150-153, 160, 161, 164,
169, 170, 327
- Бандера С. А. 241, 258, 259,
265, 272, 286
Баран Є. 272
Баранов В. М. 29, 32, 34, 35,
45, 47, 53, 54, 58
Белаль Т. 321
Блажнова О. А. 182, 184
Богдан О. В.
(Bogdan O. V.) 186, 193
Брехт Б. 236
Будулак В. І. 101, 109
Былина І. Е. 12
- Вавілова О. І. 271
Волков І. А. 136
Волощак М. 286
- Гавриленко Н. А. 311
Гевелюк С. А.
(Gevelyuk S. A.) 191, 197,
205
Гільмутдінова В. Р.
(Gilmutdinova V. R.) 212-216,
219, 224-226, 228, 315
Голембиевский Н. Н. 13, 14,
16, 85
Групп А. Г. 136
- Дейч М. В.
(Deych M. V.) 106, 112, 115,
118, 120
Дмитренко М. 272
- Довганюк Г. В.
(Dovganyuk G. V.) 201, 203,
204, 207, 209, 213, 215, 315
Довженко О. П. 50*, 251, 265,
278
Дойчо І. К.
(Doicho I. K.) 192, 205
- Емец Е. В.
(Ємець О. В., Yemets O. V.)
172, 173, 176, 177, 180, 187,
188, 190, 200
Єфімова Г. І. 270
- Жакова Т. 297
- Зелинский І. П. 290
Зехов Л. А. 107, 117, 121, 122
- Ильченко Ю. 287
- Іван Богослов 51
Іванова Т. 298
Івашків В. 272
Ірха В. І.
(Ирха В. И.) 55-57, 73, 318
- Калиниченко Л. Ф. 89, 319
Кашкаєв М. 299
Кир'ян Н. 272
Кирничук О. С.
(Kurnychuk O. S.) 224,
226-228
Кнаб О. Д. 312
Коваленко Н. П. 288
Ковыкин С. М. 312
Кокшарова Т. В. 146
Комаров М. Ф. 5, 305

* Тут і далі курсивом указані сторінки

- Конак С. В. 242, 260
 Кракалія Р. Т. 300
 Круглов І. І. 13, 14
 Крушельницький А. В. 266, 272
 Кудашов В. Н. 86
 Кузьменко І. А. 5

 Лашкар'юв В. Є.
 (Лашкарев В. Е.) 3, 6, 10
 Литовченко Л. Ф. 16, 32, 35, 45
 Лубяний В. З. 113

 Мазепа І. С. 262, 265, 272
 Манакін В. М. 272
 Марютин В. І. 28, 40, 48, 51, 52, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 76, 81, 82, 313, 317
 Махно Н. І. 54-56
 Мацюк М. 301
 Мелконян Д. В.
 (Melkonyan J. W.) 104, 111, 116, 314, 326
 Мефодовський С. І. 273
 Михайленко А. 303
 Мороз В. Л. 245
 Мороз Н. В. (Moroz N. V.),
 (Маслєва Н. В.,
 Маслєева Н. В.,
 Maslejeva N. V.) 59, 75, 80, 84, 87-89, 93, 95, 96, 100-102, 104, 106-109, 111, 113, 116, 119, 123, 124, 129, 135, 137, 139, 170, 186, 193, 314, 322

 Невірний М. 272
 Ноах Н. М. 102, 104, 325

 Овчинникова А. П. 12
 Отченашенко П. 240, 250, 268, 269

 Павліченко В. 272
 Перегінчук Т. 305
 Подоляк М. 306
 Подрезова М. О. 292
 Поліщук П. Ф. 273
 Полтавчук В. Г. 298
 Преснов В. О.
 (Преснов В. А.,
 Presnov V. O.) 3, 5, 11-19, 21, 62, 78, 229, 231, 244, 237
 Прокопович Л. П.
 (Prokopovich L. P.) 95, 96, 98, 106-108, 112, 115, 117, 118
 Пружина В. П. 292
 Птащенко О. І. 3
 Птащенко Ф. О. (Ф. А.)
 (Ptashchenko F. O.) 112, 115, 120, 126-139, 142, 143, 147, 149-152, 154, 156, 157, 159, 161-163, 166-168, 170, 171, 175-177, 180, 182-190, 193-195, 198-204, 207-209, 211-219, 221-228, 315

 Ришякевич-Пасек Е. 205
 Різників (Різниченко) О. С. 3, 255, 260, 265, 271, 272, 294, 299, 302
 Рыжиков І. В. 108

 Савин Д. П. 113
 Савченко Н. В. 275, 276
 Самодурова В. В. 292
 Сердюк В. В. 2, 5
 Сльозка М. Й. 239, 240, 246
 Солошенко В. І. 229, 295
 Сталін Й. В. 233, 265
 Строката Н. А. 268, 271, 272
 Суховецький М. М. 307-309
 Сушков В. П. 26, 38, 41, 46, 57, 85, 311

Тепляков В. А. 32, 35, 45, 312
Тимохов Ф. П. 27, 31, 33, 36,
39, 42, 49, 312, 316

Федченко Л. 310
Фролов В. Д. 312
Фусик М. И. 90, 92, 110, 324

Цап Б. В. 75, 80, 83, 86-88,
91, 93-96, 98, 99, 314, 323

Чапнин В. А. 73
Чорновол В. М. 272, 280
Чупринка Г. А. 46

Шалак О. 272
Шугарова В. В.
(Shugarova V. V.) 174-176,
179, 181, 187, 188, 194, 196,
200, 214

Щипківський Г. П. 298

Эм Рен Сик 70, 71, 74, 97,
320

Mironchenko N. V. 120
Sadova G. V. 137
Smyntyna V. A. 210



Професор О. О Птащенко, член-кореспондент Академії наук України професор В. Г. Литовченко та професор Т. І. Горбанюк біля прощальної ватри на XVI Міжнародній конференції з фізики і технології тонких плівок та наносистем, присвяченій пам'яті професора Дмитра Фреїка (2017 р., м. Яремче).



Завідувач кафедри фізики твердого тіла та твердотільної електроніки ОНУ імені І. І. Мечникова професор О. О Птащенко (в центрі) зі співробітниками кафедри і студентами під час святкування Нового 2006 року.



Олександр Птащенко (справа) і скульптор Микола Худолій (в центрі), а також актори Одеського академічного Українського музично-драматичного театру імені Василя Василька (зліва направо): заслужена артистка України Марія Пивоварова, заслужена артистка України Ірина Черкаська і заслужена артистка України Діана Мала на відкритті меморіальної дошки народному артисту України Миколі Сльозці (2013 р., вул. Ніжинська, 36).



Українська поетеса Надія Мовчан-Карпусь вітає Олександра Птащенка під час презентації його поетичної збірки «Вклоняюсь Вам» (2013 р., конференц-зал ОНУ імені І. І. Мечникова).



Олександр Птащенко (справа) серед учасників літературно-мистецького фестивалю «Степові перлини» в смт Миколаївка, на його батьківщині (2017 р.).

ЗМІСТ

Біографічна довідка	3
Хронологічний покажчик наукових праць	7
Публіцистика	38
Поетична творчість	41
Вибрані поезії	46
Література про життя, наукову, творчу та громадську діяльність	58
Авторські свідоцтва і патенти	62
Дисертації, захищені під керівництвом О. О. Птащенко	63
Алфавітний покажчик наукових праць	65
Покажчик періодичних видань	76
Покажчик імен	78

Науково-довідкове видання

**ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПТАЩЕНКО**

*Біобібліографічний покажчик
літератури*

Випуск 50

Упорядник
Анна Володимирівна Іванченко

Комп'ютерний набір і верстка
А. В. Іванченко

Видання до оприлюднення підготував
редакційний відділ
Одеської національної наукової бібліотеки
65023 Одеса-23, вул. Пастера, 13

Підписано 14.11.2018
Формат 60x84 1/16
Обсяг 4,6 обл.-вид. арк.